

正弦波駆動方式、ホールアンプ内蔵
高圧 3 相モータドライバ
SIM260xM シリーズ



データシート

概要

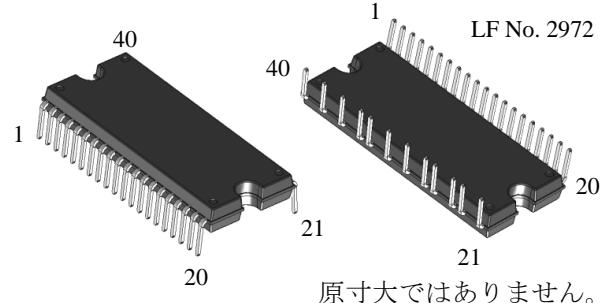
SIM260xM シリーズは、ホール素子およびホール IC 入力に対応した、正弦波駆動方式の高圧 3 相モータ用ドライバで、高効率で低騒音なモータ制御を提供します。高放熱 DIP パッケージに、制御用 IC、ゲート駆動用 IC、3 相分の出力素子とブートストラップダイオードを内蔵しており、モータ駆動回路の構成部品を大幅に削減できます。これにより、駆動回路の信頼性が向上するだけでなく、低容量な駆動回路を容易に構成できます。ユニバーサル入力仕様の低～中容量モータのインバータ制御に最適です。

特長

- Pb フリー (RoHS 対応)
- SIM2601MA :
絶縁耐圧 1500 V (1 分) 保証 (UL 申請中)
SIM2602M :
絶縁耐圧 1500 V (1 分) 保証
UL 認定済み (File No.: E118037)
- 低騒音、高効率 (正弦電流波形)
- 部品点数削減
ブートストラップダイオード内蔵
- ホール素子およびホール IC 入力対応
- 外部信号で、アプリケーションに応じた最適な設定が可能
 - 回転速度
 - 進角値
 - 回転方向
 - モータロック検出有無
- 5 V 基準電圧出力
(ホール素子の駆動などに使用)
- 保護回路動作時エラー信号出力 (FO 端子)
- 保護機能
 - VREG 端子電圧低下保護 (UVLO_REG)
 - 電源電圧低下保護
VBx 端子 (UVLO_VB)
VCC 端子 (UVLO_VCC)
 - 過電流制限 (OCL)
 - 過電流保護 (OCP)
 - サーマルシャットダウン (TSD)
 - モータロック保護 (MLP)
 - 逆回転検出
 - ホール信号異常検出

パッケージ

DIP40 (ボディサイズ : 36.0 mm × 14.8 mm × 4.0 mm)



原寸大ではありません。

SIM260xM シリーズ

- 出力耐圧 : 600 V

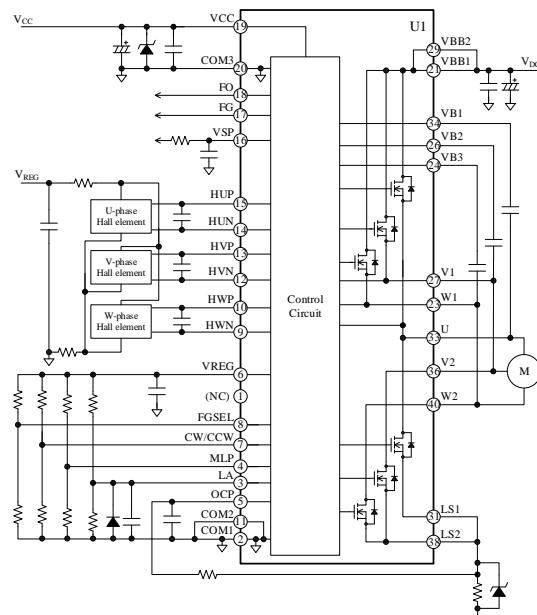
電流定格	製品名	出力素子
2.5 A	SIM2601MA*	パワー MOSFET
5.0 A	SIM2602M	IGBT + FRD

*開発中

アプリケーション

- 洗濯乾燥機のファン・ポンプ駆動
- エアコンのファンモータ駆動
- 空気清浄機・扇風機のファンモータ駆動

応用回路例



目次

概要	1
目次	2
1. 絶対最大定格	4
2. 推奨動作条件	5
3. 電気的特性	6
3.1 制御部特性	6
3.2 ブートストラップダイオード特性	7
3.3 スイッチング素子特性	8
3.3.1 SIM2601MA	8
3.3.2 SIM2602M	9
3.4 熱抵抗	10
4. 機械的特性	11
5. 絶縁距離	11
6. プロックダイアグラム	12
7. 各端子機能	13
8. 応用回路例	14
9. 外形図	16
10. 捺印仕様	17
11. 機能説明	18
11.1 端子説明	18
11.1.1 COM1、COM2、COM3 端子	18
11.1.2 LA 端子	18
11.1.3 MLP 端子	18
11.1.4 OCP 端子	18
11.1.5 VREG 端子	18
11.1.6 CW/CCW 端子	19
11.1.7 FGSEL 端子	19
11.1.8 HUP、HVP、HWN 端子、 HUN、HVN、HWP 端子	19
11.1.9 VSP 端子	19
11.1.10 FG 端子	19
11.1.11 FO 端子	20
11.1.12 VCC 端子	20
11.1.13 VBB1、VBB2 端子	20
11.1.14 VB1、VB2、VB3 端子	20
11.1.15 U、V1、V2、W1、W2 端子	20
11.1.16 LS1、LS2 端子	20
11.2 起動動作	21
11.3 ブートストラップコンデンサの充電	21
11.4 速度制御	22
11.5 進角機能	22
11.6 エラー出力	27
11.7 保護機能	27
11.7.1 VREG 端子電圧低下保護機能 (UVLO_VREG)	27
11.7.2 電源電圧低下保護機能 (UVLO)	27
11.7.3 過電流制限機能 (OCL)、過電流保護機能 (OCP)	27

SIM260xM シリーズ

11.7.4 サーマルシャットダウン (TSD)	28
11.7.5 モータロック保護機能 (MLP)	28
11.7.6 逆回転検出機能	28
11.7.7 ホール信号異常検出機能	28
12. 設計上の注意点	30
12.1 パターンレイアウト	30
12.2 IC の特性を測定する際の注意	30
12.3 放熱器を取り付ける際の注意	31
13. 損失の計算とジャンクション温度の推定	31
13.1 パワーMOSFET の場合	31
13.1.1 パワーMOSFET の定常損失 P_{RON}	31
13.1.2 パワーMOSFET のスイッチング損失 P_{SW}	32
13.1.3 ボディーダイオードの定常損失 P_{SD}	32
13.1.4 パワーMOSFET のジャンクション温度の推定	32
13.2 IGBT の場合	33
13.2.1 IGBT の定常損失 P_{ON}	33
13.2.2 IGBT のスイッチング損失 P_{SW}	33
13.2.3 IGBT のジャンクション温度の推定	33
14. 代表特性グラフ	34
14.1 過渡熱抵抗特性グラフ	34
14.2 制御部代表特性グラフ	35
14.3 出力特性グラフ	39
14.3.1 出力素子特性グラフ	39
14.3.2 スイッチング損失特性グラフ	40
14.4 許容実効電流特性グラフ	41
14.4.1 SIM2601MA	41
14.4.2 SIM2602M	41
14.5 短絡 SOA	42
15. パターンレイアウト例	43
16. モータドライバ回路例	45
注意書き	46

SIM260xM シリーズ

1. 絶対最大定格

電流値の極性は、IC を基準にして流入（シンク）を“+”、流出（ソース）を“-”と規定します。

特記がない場合の条件は $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。また COM1、COM2、COM3 端子を短絡し、その電位を COM と示します。

項目	記号	条件	定格	単位	備考
主電源電圧（連続） ⁽¹⁾	V_{DC}	$V_{BBx}-LSx$ 間	450	V	SIM2602M
主電源電圧（サーボ） ⁽¹⁾	$V_{DC(SURGE)}$	$V_{BBx}-LSx$ 間	500	V	SIM2602M
パワーMOSFET/IGBT 出力耐圧	V_{DSS}	$I_D = 100 \mu\text{A}$	600	V	SIM2601MA
	V_{CES}	$I_C = 1 \text{ mA}$	600	V	SIM2602M
制御電源電圧	V_{CC}	$V_{CC}-COM$ 間	20	V	
	V_{BS}	$VB1-U$ 間、 $VB2-V1$ 間、 $VB3-W1$ 間	20	V	
出力電流（連続） ⁽²⁾	I_O	$T_C = 25^\circ\text{C}$ 、 $T_J < 150^\circ\text{C}$	2.5	A	SIM2601MA
			5.0		SIM2602M
出力電流（パルス）	I_{OP}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ 、 パルス幅 $\leq 100 \mu\text{s}$	3.75	A	SIM2601MA
			7.5		SIM2602M
VREG 端子出力電圧	V_{REG}		5.5	V	
VREG 端子出力電流	I_{REG}		30	mA	
入力電圧 1 (HUP、HUN、HVP、 HVN、HWP、HWN)	$V_{IN(1)}$		$-0.5 \sim V_{REG}$	V	
入力電圧 2 (LA、MLP、OCP、 CW/CCW、FGSEL)	$V_{IN(2)}$		$-0.5 \sim V_{REG}$	V	
入力電圧 3 (VSP)	$V_{IN(3)}$		$-0.5 \sim 10$	V	
出力電圧 (FG、FO)	V_O		$-0.5 \sim V_{REG}$	V	
LSx 端子電圧（連続）	$V_{LS(DC)}$	$LSx-COM$ 間	$-0.7 \sim 7$	V	
LSx 端子電圧（サーボ）	$V_{LS(SURGE)}$	$LSx-COM$ 間	$-4 \sim 7$	V	
動作ケース温度 ⁽³⁾	$T_{C(OP)}$		$-30 \sim 100$	$^\circ\text{C}$	
ジャンクション温度 ⁽⁴⁾	T_J		150	$^\circ\text{C}$	
保存温度	T_{STG}		$-40 \sim 150$	$^\circ\text{C}$	

⁽¹⁾ IGBT を搭載した製品のみ規定

⁽²⁾ 実際のケース温度に応じたディレーティングが必要 (14.4 項 許容実効電流特性グラフ参照)

⁽³⁾ IC 動作時のケース温度

⁽⁴⁾ IC 内部の各チップ（制御部、ゲート駆動部、出力素子）のジャンクション温度

SIM260xM シリーズ

2. 推奨動作条件

特記がない場合、COM1、COM2、COM3 端子を短絡し、その電位を COM と示します。

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
主電源電圧	V _{DC}	VBBx–LSx 間	—	300	400	V	
制御電源電圧	V _{CC}	VCC–COM 間	13.5	—	16.5	V	
	V _{BS}	VB1–U 間、 VB2–V1 間、 VB3–W1 間	13.5	—	16.5	V	
入力電圧 1 (HUP、HUN、 HVP、HVN、HWP、HWN)	V _{IN(1)}		0	—	5.0	V	
入力電圧 2 (MLP、CW/CCW、 FGSEL)	V _{IN(2)}		0	—	5.0		
入力電圧 3 (VSP)	V _{IN(3)}		0	—	5.4	V	
FO 端子ノイズ除去用 コンデンサ	C _{FO}		0.001	—	0.01	μF	
ブーストトラップコンデンサ	C _B		1	—	—	μF	
シャント抵抗*	R _S	I _{OP} ≤ 3.75 A	176	—	—	mΩ	SIM2601MA
		I _{OP} ≤ 7.5 A	88	—	—		SIM2602M
RC フィルタ抵抗	R _O		—	—	100	Ω	
RC フィルタコンデンサ	C _O		100	—	2200	pF	
動作ケース温度	T _{C(OP)}		—	—	100	°C	

* インダクタンス成分が小さい抵抗を使用してください。

3. 電気的特性

電流値の極性は、IC を基準にして流入（シンク）を“+”、流出（ソース）を“-”と規定します。

特記がない場合の条件は $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{CC} = 15\text{ V}$ です。また、COM1、COM2、COM3 端子を短絡し、その電位を COM と示します。

3.1 制御部特性

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
電源部						
ローサイド制御動作開始電圧	$V_{CC(ON)}$	VCC-COM 間	10.5	11.5	12.5	V
ローサイド制御動作停止電圧	$V_{CC(OFF)}$		10.0	11.0	12.0	V
ハイサイド制御動作開始電圧	$V_{BS(ON)}$	VB1-U 間、VB2-V1 間、 VB3-W1 間	9.5	10.5	11.5	V
ハイサイド制御動作停止電圧	$V_{BS(OFF)}$		9.0	10.0	11.0	V
制御電源電流	I_{CC}	$V_{SP} = 5.4\text{ V}$ 、 $I_{REG} = 0\text{ A}$	—	5.5	—	mA
	I_{BS}	$V_{Bx} = 15\text{ V}$ 、 $V_{SP} = 5.4\text{ V}$ 、 1相あたりの V_{Bx} 端子 電流	40	140	350	μA
VREG 端子出力電圧	V_{REG}	$I_{REG} = 0\text{ mA} \sim 30\text{ mA}$	4.5	5.0	5.5	V
入力信号部⁽¹⁾						
入力しきい電圧 (MLP、FGSEL、CW/CCW)	V_{TH}		2.25	2.50	2.75	V
ハイレベル入力電流 1 (LA、MLP、 CW/CCW、FGSEL、VSP)	I_{IH1}	$V_{IN} = V_{REG}$	—	25	100	μA
ローレベル入力電流 1 (LA、MLP、 CW/CCW、FGSEL、VSP)	I_{IL1}	$V_{INL} = 0\text{ V}$	—	—	2	μA
ハイレベル入力電流 2 (OCP)	I_{IH2}	$V_{IN} = V_{REG}$	-5	—	5	μA
ローレベル入力電流 2 (OCP)	I_{IL2}	$V_{INL} = 0\text{ V}$	—	23	90	μA
ハイレベル入力電流 3 (HUP、 HUN、HVP、HVN、HWP、HWN)	I_{IH3}	$V_{IN} = V_{REG}$	-5	—	5	μA
ローレベル入力電流 3 (HUP、 HUN、HVP、HVN、HWP、HWN)	I_{IL3}	$V_{INL} = 0\text{ V}$	-5	—	5	μA
ハイレベル出力電圧 (FG、FO)	V_{OH}		4.5	—	5.5	V
ローレベル出力電圧 (FG、FO)	V_{OL}		—	—	0.5	V

⁽¹⁾ 設計保証

SIM260xM シリーズ

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
PWM 制御						
キャリア周波数 ⁽²⁾	f_C		16	17	18	kHz
内部発振器周波数 ⁽²⁾	f_{OSC}		4.10	4.32	4.54	MHz
デッドタイム ⁽²⁾	t_D		—	1.2	—	μs
制御 IC 出力パルスデューティ (ローサイド) ⁽²⁾	D	$V_{SP} = 1.5 V$ 、ブートストラップコンデンサ充電	—	6.3	—	%
制御 IC 出力パルスデューティ (ハイサイド) ⁽²⁾	D	$V_{SP} = 2.0 V$	—	0	3	%
		$V_{SP} = 3.7 V$	47	50	53	%
		$V_{SP} = 5.0 V$ (120° 通電駆動)	85.0	—	88.9	%
		$V_{SP} = 5.4 V$ (180° 通電駆動)	93.7	—	100	%
保護機能						
電流制限しきい電圧	V_{LIM}		0.25	0.30	0.35	V
電流制限ブランкиング時間	$t_{BK(OCL)}$		—	2.3	4.5	μs
過電流保護しきい電圧	V_{TRIP}		0.54	0.60	0.66	V
過電流保護ブランкиング時間	$t_{BK(OCP)}$		—	0.8	1.7	μs
過電流保護保持時間	t_P		—	15	—	ms
モータロック保護検出時間	t_{LD}		—	5	—	s
モータロック保護保持時間	t_{LH}		—	64	—	s
サーマルシャットダウン動作温度 ⁽³⁾	T_{DH}	$I_{REG} = 0 mA$ 、 放熱器なし	—	130	—	°C
サーマルシャットダウン ヒステリシス温度 ⁽³⁾	$T_{D(HYS)}$		—	30	—	°C
VREG 端子電圧低下保護動作電圧 ⁽²⁾	V_{UVRL}		3.24	3.60	3.96	V
VREG 端子電圧低下保護解除電圧 ⁽²⁾	V_{UVRH}		3.60	4.00	4.40	V

⁽²⁾ 内部信号、設計保証

⁽³⁾ ゲート駆動部のジャンクション温度

3.2 ブートストラップダイオード特性

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
ブートストラップダイオード リーク電流	I_{LBD}	$V_R = 600 V$	—	—	100	μA
ブートストラップダイオード順電圧	V_{FB}	$I_{FB} = 10 mA$ 、制限抵抗 R_{BOOT} の電圧降下を含む	—	3.0	—	V

3.3 スイッチング素子特性

本項に示すスイッチング特性の定義は図 3-1 のとおりです。内部信号 HIN_x、LIN_x を V_{IN} と定義します（6 項参照）。

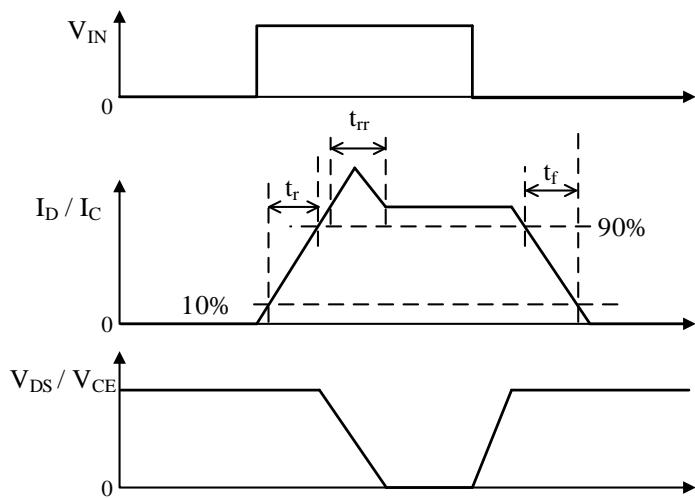


図 3-1 スイッチング時間の定義

3.3.1 SIM2601MA

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
ドレイン-ソース間漏れ電流	I _{DSS}	V _{DS} = 600 V、V _{IN} = 0 V	—	—	100	μA
ドレイン-ソース間オン抵抗	R _{DS(ON)}	I _D = 1.25 A、V _{IN} = 5 V	—	2.0	2.5	Ω
ソース-ドレイン間ダイオード 順電圧	V _{SD}	I _{SD} = 1.25 A、V _{IN} = 0 V	—	1.0	1.5	V
ハイサイドスイッチング特性						
ソース-ドレイン間ダイオード 逆回復時間*	t _{rr}	V _{DC} = 300 V、 I _D = 1.25 A、 V _{IN} = 0 V ↔ 5 V、 T _J = 25 °C、 誘導負荷	—	100	—	ns
上昇時間*	t _r		—	50	—	ns
下降時間*	t _f		—	35	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ソース-ドレイン間ダイオード 逆回復時間*	t _{rr}	V _{DC} = 300 V、 I _D = 1.25 A、 V _{IN} = 0 V ↔ 5 V、 T _J = 25 °C、 誘導負荷	—	100	—	ns
上昇時間*	t _r		—	55	—	ns
下降時間*	t _f		—	20	—	ns

* 設計保証

SIM260xM シリーズ

3.3.2 SIM2602M

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクタ-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 5.0 \text{ A}, V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.75	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 5.0 \text{ A}, V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	2.0	2.4	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間*	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}, I_C = 5.0 \text{ A}, V_{IN} = 0 \text{ V} \leftrightarrow 5 \text{ V}, T_J = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	—	100	—	ns
上昇時間*	t_r	$T_J = 25 \text{ }^{\circ}\text{C},$ 誘導負荷	—	110	—	ns
下降時間*	t_f		—	210	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間*	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}, I_C = 5.0 \text{ A}, V_{IN} = 0 \text{ V} \leftrightarrow 5 \text{ V}, T_J = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	—	100	—	ns
上昇時間*	t_r	$T_J = 25 \text{ }^{\circ}\text{C},$ 誘導負荷	—	110	—	ns
下降時間*	t_f		—	210	—	ns

* 設計保証

3.4 热抵抗

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
ジャンクション-ケース間熱抵抗 ⁽¹⁾	R_{J-C}	パワーMOSFET 全素子動作時	—	—	3.6	°C/W	SIM2601MA
	$R_{(J-C)Q}^{(2)}$	IGBT 全素子動作時	—	—	3.6	°C/W	SIM2602M
	$R_{(J-C)F}^{(3)}$	フリーホイールダイ オード全素子動作時	—	—	4.2	°C/W	SIM2602M
ジャンクション-周囲間熱抵抗	R_{J-A}	パワーMOSFET 全素子動作時	—	—	25	°C/W	SIM2601MA
	$R_{(J-A)Q}$	IGBT 全素子動作時	—	—	25	°C/W	SIM2602M
	$R_{(J-A)F}$	フリーホイールダイ オード全素子動作時	—	—	29	°C/W	SIM2602M

(1) ケース温度は図 3-2 で規定。

(2) 内部スイッチング素子のジャンクションとケース間の定常熱抵抗（過渡熱特性は 14.1 項を参照）

(3) 内部フリーホイールダイオードのジャンクションとケース間の定常熱抵抗

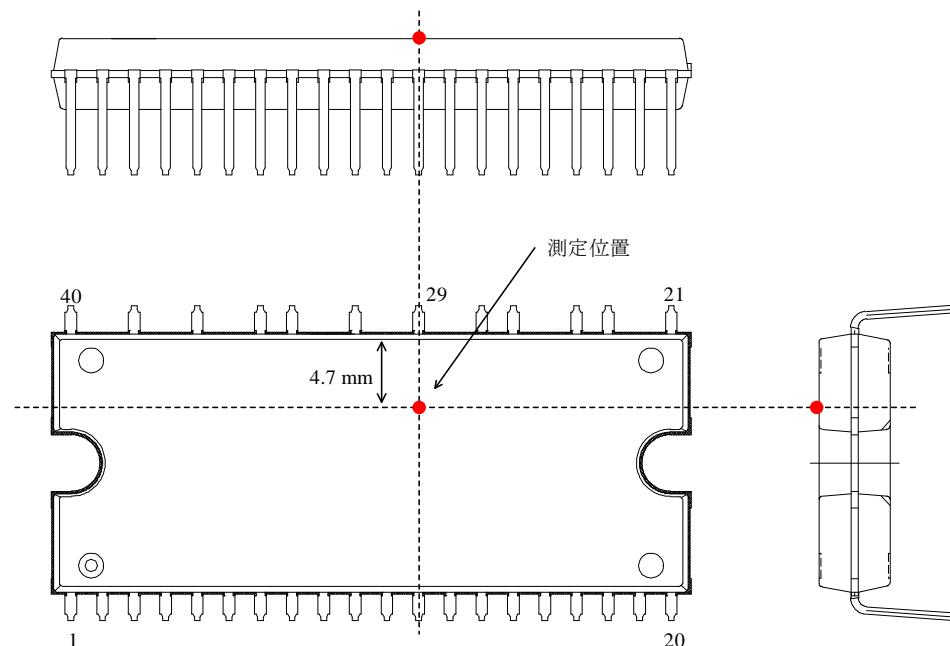


図 3-2 ケース温度測定位置

4. 機械的特性

項目	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
締付けトルク	*	0.294	—	0.441	N·m	
放熱面平坦度	図 4-1 参照	0	—	60	μm	
質量		—	5.2	—	g	

* φ6.0 の平座金と M2.5 のネジを使用してください。締付けの際の注意事項は、12.3 項を参照してください。

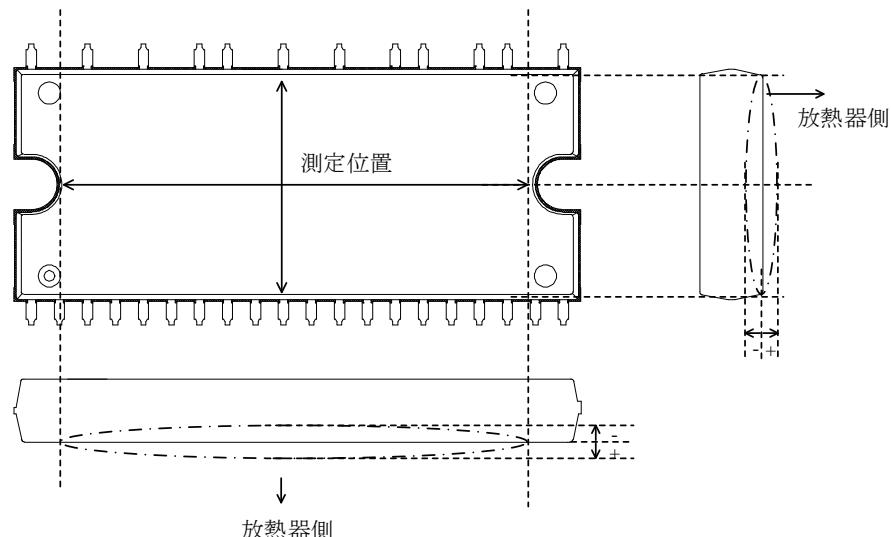


図 4-1 放熱面平坦度測定位置

5. 絶縁距離

項目	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
空間距離	放熱器* - リード間	1.5	—	2.1	mm	
沿面距離	図 5-1 参照	1.7	—	—	mm	

* 放熱器の形状が平坦の場合です。本規格値以上の空間距離を確保する場合は、放熱器の形状を凸にするなどの対応が必要です。

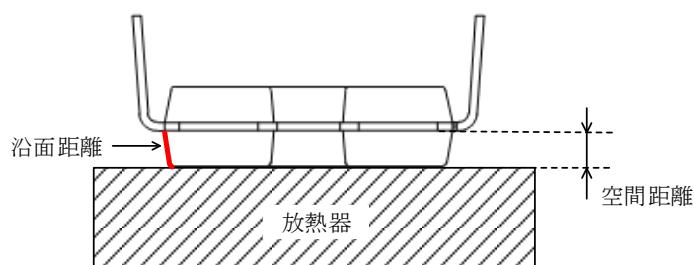


図 5-1 絶縁距離測定位置

SIM260xM シリーズ

6. ブロックダイアグラム

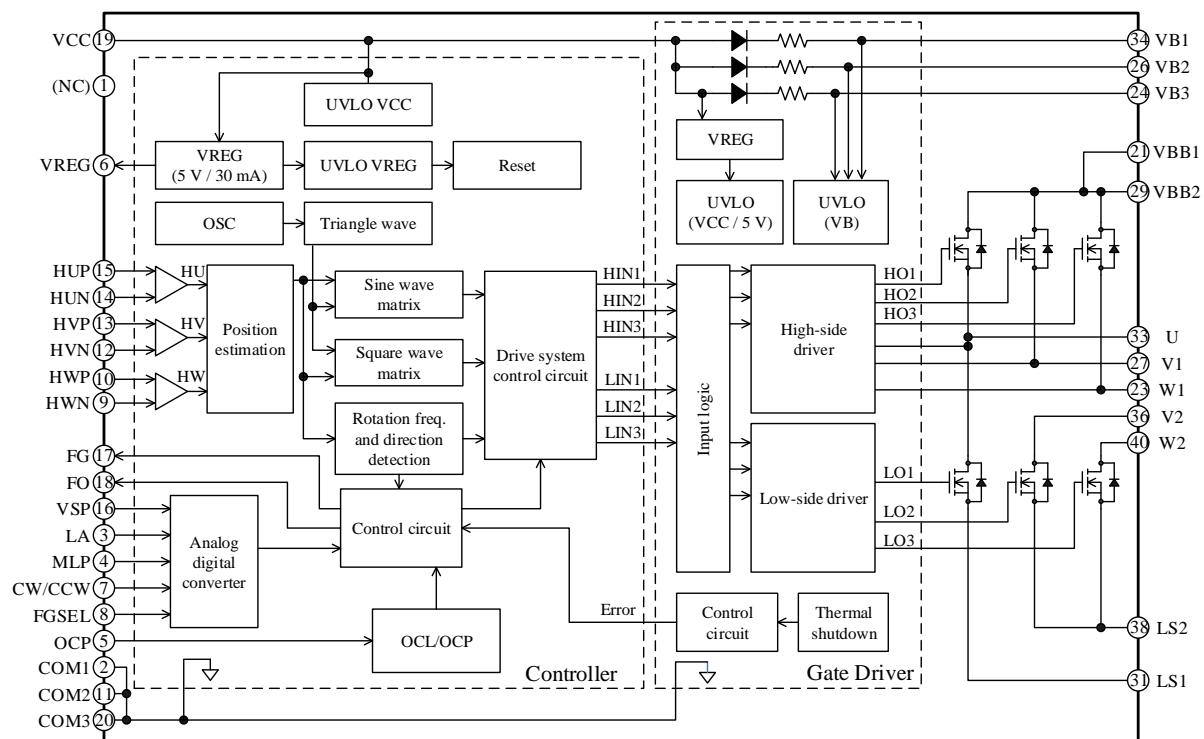


図 6-1 SIM2601MA ブロックダイアグラム

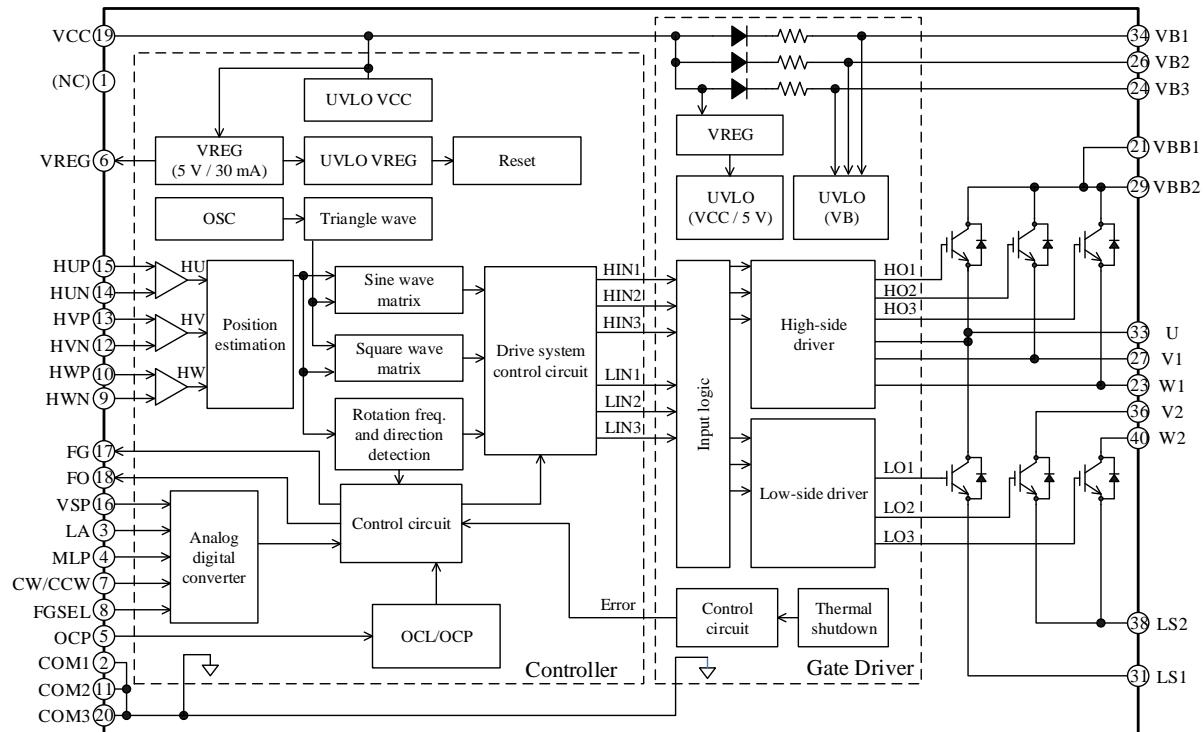


図 6-2 SIM2602M ブロックダイアグラム

7. 各端子機能

上面図

	端子番号	端子名	機能
1	(NC)	1	NC (非接続)
2	COM1	2	COM1 制御グランド
3	LA	3	LA 進角値設定信号入力
4	MLP	4	MLP モータロック保護機能有効／無効設定
5	OCP	5	OCP 過電流検出信号入力
6	VREG	6	VREG 内部レギュレータ出力
7	CW/CCW	7	CW/CCW 回転方向設定信号入力
8	FGSEL	8	FG 端子設定信号入力
9	HWN	9	HWN W 相ホール素子信号 (-) 入力
10	HWP	10	HWP W 相ホール素子信号 (+) 入力
11	COM2	11	COM2 制御グランド
12	HVN	12	HVN V 相ホール素子信号 (-) 入力
13	HVP	13	HVP V 相ホール素子信号 (+) 入力
14	HUN	14	HUN U 相ホール素子信号 (-) 入力
15	HUP	15	HUP U 相ホール素子信号 (+) 入力
16	VSP	16	VSP 速度制御信号入力
17	FG	17	FG 回転パルス信号出力
18	FO	18	FO エラー信号出力
19	VCC	19	VCC 制御回路電源入力
20	COM3	20	COM3 制御グランド
		21	VBB1 DC (+) 電源入力
		22	— 抜きピン
		23	W1 W 相出力 (W2 端子と外部ショート)
		24	VB3 W 相ハイサイド・フローティング電源入力
		25	— 抜きピン
		26	VB2 V 相ハイサイド・フローティング電源入力
		27	V1 V 相出力 (V2 端子と外部ショート)
		28	— 抜きピン
		29	VBB2 DC (+) 電源入力
		30	— 抜きピン
		31	LS1 U 相ローサイドパワーMOSFET ソース / IGBT エミッタ (LS2 と外部ショート)
		32	— 抜きピン
		33	U U 相出力
		34	VB1 U 相ハイサイド・フローティング電源入力
		35	— 抜きピン
		36	V2 V 相出力 (V1 端子と外部ショート)
		37	— 抜きピン
		38	LS2 V 相、W 相ローサイドパワーMOSFET ソース / IGBT エミッタ (LS1 と外部ショート)
		39	— 抜きピン
		40	W2 W 相出力 (W1 端子と外部ショート)

8. 応用回路例

図 8-1 にホール素子の信号を入力する場合、図 8-2 にホール IC の信号を入力する場合の応用回路例を示します。

各端子にサージが印加されると、IC の誤動作の原因になったり、サージ電圧が絶対最大定格を超えると IC の破壊の原因になったりします。そのため、必要に応じて CR フィルタ回路やツェナーダイオードなどを各端子に追加し、問題がないか実験で確認をしてください。

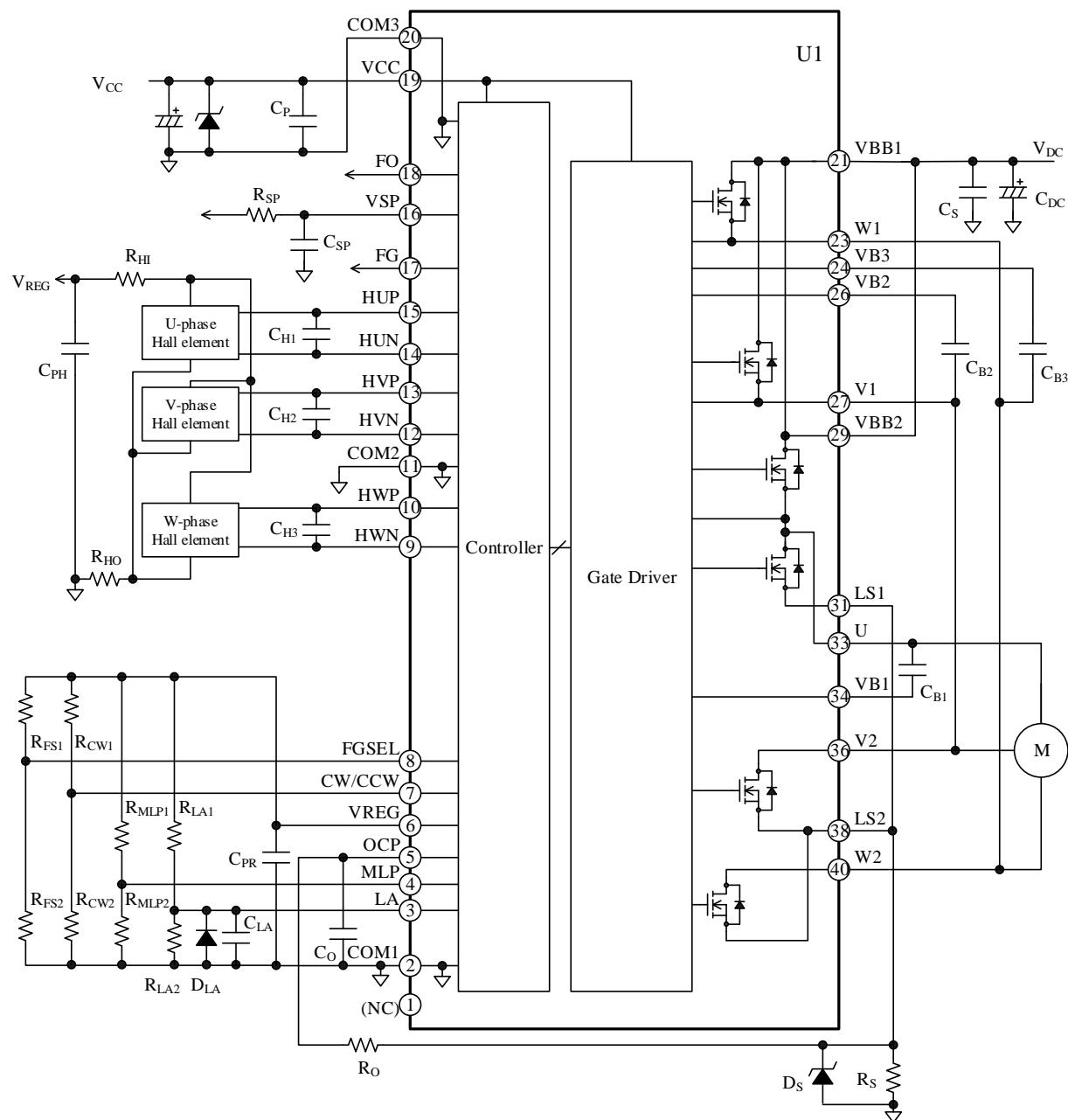


図 8-1 ホール素子の信号を入力する場合

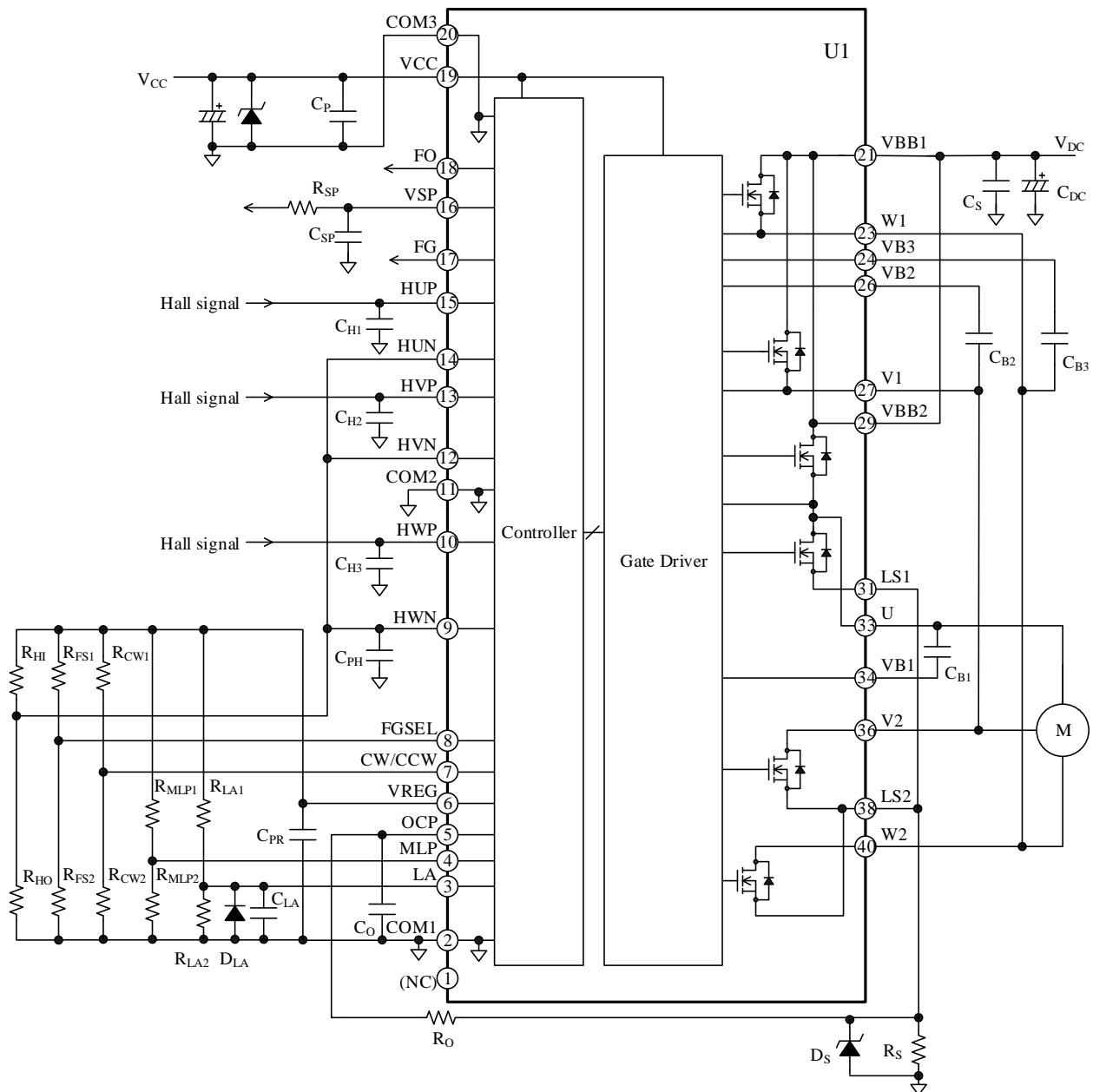
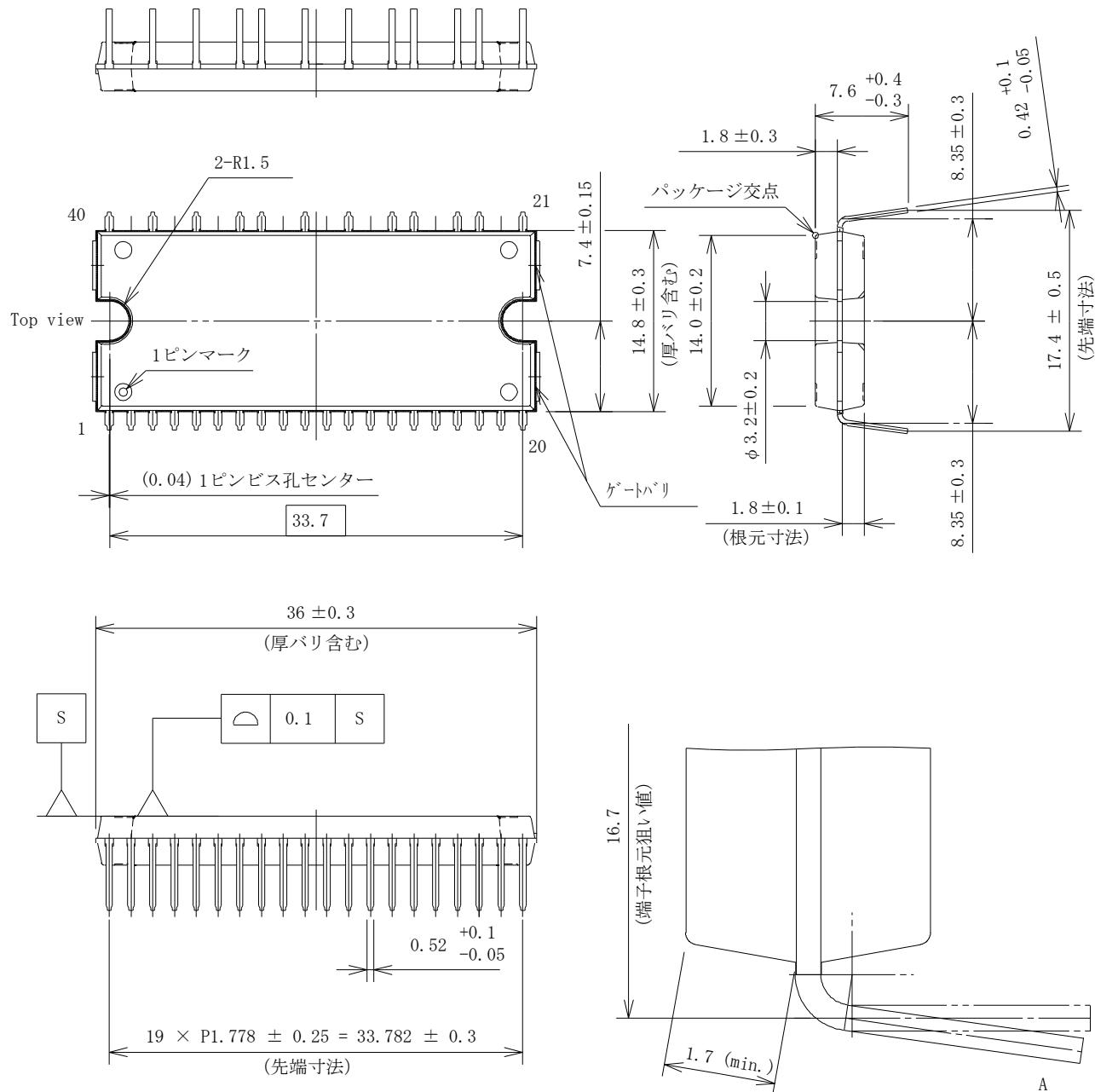


図 8-2 ホール IC の信号を入力する場合

SIM260xM シリーズ

9. 外形図

● DIP40 パッケージ

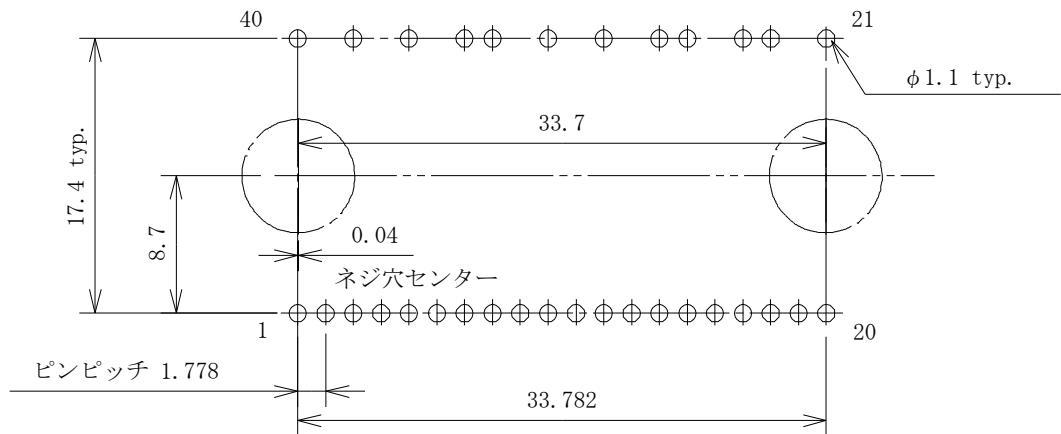


備考 :

- 単位 : mm
- Pb フリー (RoHS 対応)
- A 部の寸法 (端子部の曲げ状態) は、実際と異なる場合があります
- ゲートバリ高さ : 0.3 mm (max.)

SIM260xM シリーズ

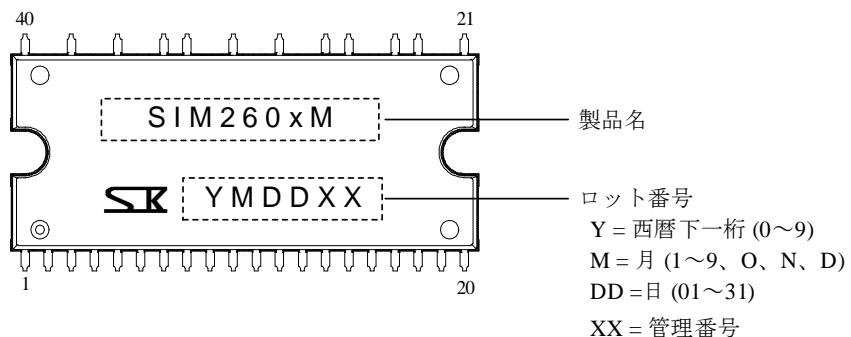
- フットパターン例
- 部品挿入穴サイズ、レイアウト（参考）



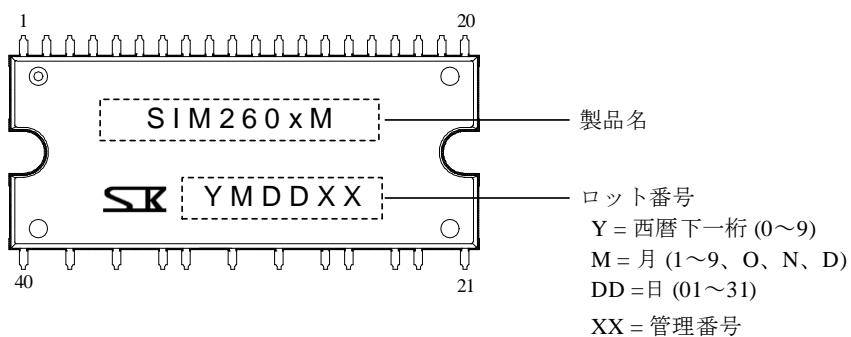
単位 : mm

10. 摺印仕様

- 表捺印



- 裏捺印



11. 機能説明

特記のない場合、本項では以下のように定義します。

- 本項では 3 項の電気的特性項目の記号と、8 項の応用回路例の部品記号を使用しています。特記のない場合、特性数値は Typ. 値を表記します。
- 説明に使用する回路図はパワー MOSFET タイプです。IGBT タイプの IC の機能は、パワー MOSFET タイプと同等です。
- 端子記号や部品記号の数字（1～3 など）や記号（U、V、W など）を“x”で表記している場合は、そのすべての端子や部品を指します。たとえば、“VB_x 端子”は VB1 端子、VB2 端子、VB3 端子を指します。

11.1 端子説明

11.1.1 COM1、COM2、COM3 端子

COM1、COM2、COM3 端子は IC の制御グランド端子です。これらの端子は IC 内部で接続されています。制御グランドの電位が変動すると IC の誤動作の原因になるため、制御グランドの配線はパワーグランドと分けて、シャント抵抗 R_S のできるだけ近くに 1 点でかつできるだけ短く接続します（図 11-1 参照）。

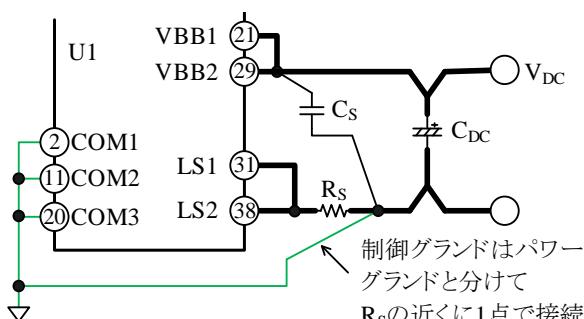


図 11-1 制御グランドの配線

11.1.2 LA 端子

本 IC は進角機能を搭載しています。LA 端子に入力したアナログ電圧によって進角値が決まります。LA 端子の設定および進角機能の詳細は 11.5 項を参照してください。

11.1.3 MLP 端子

MLP 端子でモータロック保護機能の有効／無効を設定します。表 11-1 に MLP 端子の論理を示します。本 IC は、起動時 (VCC 端子電圧上昇時) に MLP 端子の論理を検出します。図 11-2 に MLP 端子の内部回路図を示します。“L”にするときは GND 端子に、“H”にするときは VREG 端子に MLP 端子を接続します。モータロック保護機能の詳細は 11.7.5 項を参照してください。

表 11-1 モータロック保護機能

MLP 端子	モータロック保護機能
L	有効
H	無効

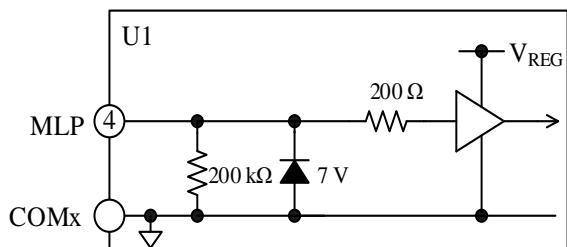


図 11-2 MLP 端子の内部回路図

11.1.4 OCP 端子

出力素子に流れる電流の過電流保護信号を入力する端子です。OCP 端子に入力される電圧レベルに応じて、過電流制限機能 (OCL) か過電流保護機能 (OCP) が動作します。OCP 端子の周辺部品の設定および、これらの保護機能の詳細は、11.7.3 項を参照してください。

11.1.5 VREG 端子

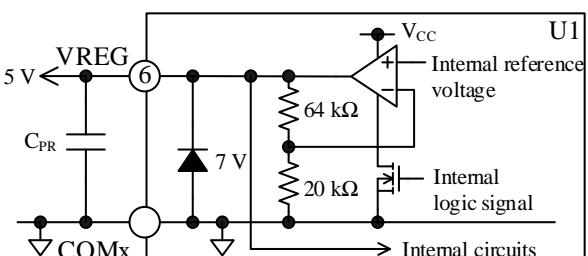


図 11-3 VREG 端子の内部回路図

5.0 V レギュレータ出力です。ホール素子の電源

SIM260xM シリーズ

などに使用できます。最大出力電流は 30 mA です。VREG 端子の出力を安定させるため、0.1 μF 程度のコンデンサ C_{PR} を接続します。VREG 端子は、電源電圧低下保護機能を搭載しています。詳細は 11.7.1 項を参照してください。

11.1.6 CW/CCW 端子

回転方向の設定端子です。表 11-2 にモータの回転方向と CW/CCW 端子の論理、図 11-4 に CW/CCW 端子の内部回路を示します。“L”にするときは GND 端子に、“H”にするときは VREG 端子に CW/CCW 端子を接続します。本 IC は、起動時 (VCC 端子電圧上昇時) に CW/CCW 端子の論理を検出します。

表 11-2 モータの回転方向

CW/CCW 端子	モータの回転方向
L	時計回り (CW)
H	反時計回り (CCW)

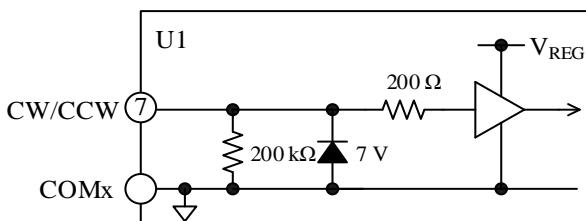


図 11-4 CW/CCW 端子の内部回路図

11.1.7 FGSEL 端子

FGSEL 端子で、FG 端子から出力される回転パルス信号の周期を設定します。表 11-3 に電気角 360°あたりの回転パルス信号の発生回数と FGSEL 端子の論理の関係を、図 11-5 に FGSEL 端子の内部回路を示します。“L”にするときは GND 端子に、“H”にするときは VREG 端子に FGSEL 端子を接続します。本 IC は、起動時 (VCC 端子電圧上昇時) に FGSEL 端子の論理を検出します。

表 11-3 回転パルス信号の発生回数

FGSEL 端子	回転パルス信号の発生回数
L	3 回／電気角 360°
H	1 回／電気角 360°

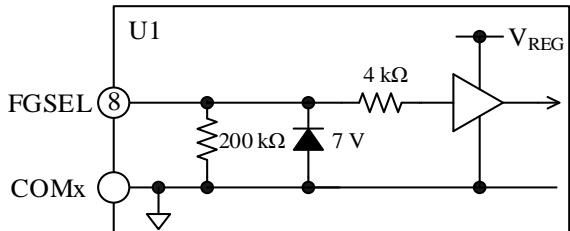


図 11-5 FGSEL 端子の内部回路図

11.1.8 HUP、HVP、HWN 端子、 HUN、HVN、HWP 端子

ホール素子の信号を入力します。HxP 端子には、プラス側、HxN 端子にはマイナス側の信号を入力します。また、図 11-6 のように、HxP 端子と HxN 端子間にはノイズ除去用のコンデンサ C_{Hx} (0.01 μF 程度) を接続します。 C_{Hx} は IC の近くに配置し、できるだけ短いパターンで IC に接続します。本 IC は、ホール素子の異常信号を検出する機能を搭載しています (11.7.7 項参照)。

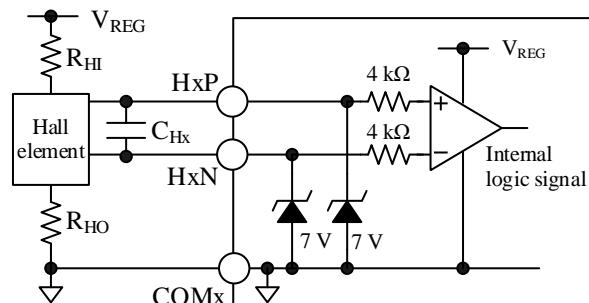


図 11-6 HxP 端子、HxN 端子の内部回路

11.1.9 VSP 端子

VSP 端子にアナログ電圧を入力することでモータの回転速度を制御できます。速度制御の詳細は、11.4 項を参照してください。

11.1.10 FG 端子

FG 端子は、位置検出信号に基づいた回転パルス信号を出力します。回転パルス信号は U、V、W 相のホール素子信号の各エッジで反転します。FG 端子は図 11-7 のように、内部で COMx 端子にプルダウンされています。

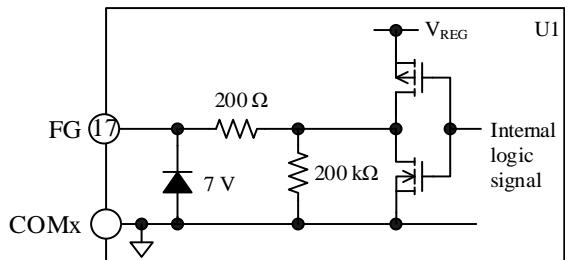


図 11-7 FG 端子の内部回路図

11.1.11 FO 端子

FO 端子は、エラー信号の出力端子です。機能の詳細は 11.6 項を参照してください。図 11-8 に FO 端子の内部回路を示します。FO 端子は、直接マイコンの入力端子に接続できます。過電流保護機能 (OCP) が動作した場合、繰り返しの OCP 動作を避けるため、マイコンは、エラー信号が出力されてから $t_P = 15 \text{ ms}$ 以内に IC の入力信号を停止する必要があります（詳細は 11.7.3 項参照）。

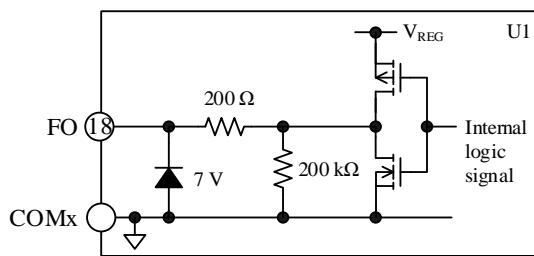


図 11-8 FO 端子の内部回路図

11.1.12 VCC 端子

VCC 端子は IC の制御回路電源入力端子です。VCC 端子は、電源電圧低下保護機能（11.7.2.2 項参照）を搭載しています。電源リップルなどによる誤動作を防止するため、各端子にできるだけ短いパターンでコンデンサ C_P ($0.01 \mu\text{F} \sim 0.1 \mu\text{F}$) を接続します。また、サージ電圧による破壊を防止するため、VCC 端子と COMx 端子間にツェナーダイオード DZ (18 V ~ 20 V) を接続します。VCC 端子と COMx 端子間に印加する電圧は、推奨制御電源電圧 V_{CC} (2 項参照) を満たすように設定します。

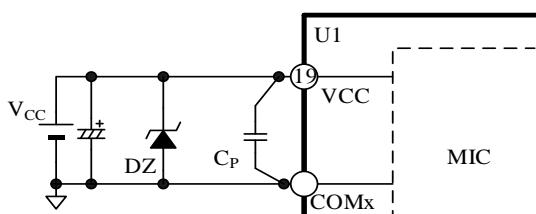


図 11-9 VCC 端子周辺回路

11.1.13 VBB1、VBB2 端子

VBB1、VBB2 端子は、DC (+) 電源入力端子です。全相のハイサイド出力素子のドレイン（コレクタ）に接続されています。VBBx 端子と COMx 端子の間に印加する電圧は、主電源電圧 V_{DC} (2 項参照) を満たすように設定します。

VBBx 端子には、サージ電圧を抑えるためコンデンサ C_S ($0.01 \mu\text{F} \sim 0.1 \mu\text{F}$) を接続します。 C_S は平滑用電解コンデンサ C_{DC} と VBBx 端子のできるだけ近くに配置し、VBBx 端子に最短で接続します。

11.1.14 VB1、VB2、VB3 端子

VB1、VB2、VB3 端子にはハイサイド・フローティング電源のブートストラップコンデンサ C_{Bx} を接続します。起動時は、ローサイドの出力素子をオンして、 C_{Bx} を十分に充電します。起動シーケンスに関しては 11.2 項、ブートストラップコンデンサの充電については 11.3 項を参照してください。

C_{Bx} ($1 \mu\text{F}$ 程度) は必ず IC の近くに配置し、できるだけ短いパターンで VBx 端子と出力端子 (U、V1、W1) 間に接続します。また、VBx 端子は、電源電圧低下保護機能を搭載しています。詳細は 11.7.2.1 項を参照してください。

11.1.15 U、V1、V2、W1、W2 端子

これらの端子は U 相、V 相、W 相の出力端子で、モータに接続します。V1 端子と V2 端子、W1 端子と W2 端子は、基板上で必ず接続してください。また、U、V1、W1 端子は、それぞれ VB1、VB2、VB3 に対する基準端子です。U、V1、W1 端子には、ブートストラップコンデンサ C_{Bx} のマイナス側を接続します。出力端子 (U、V1、V2、W1、W2) には高圧が印加されるため、基板レイアウトで低圧ラインと十分に距離を確保したり、端子にコーティング剤を塗布したりするなど、絶縁対策が必要です。

11.1.16 LS1、LS2 端子

LS1 端子には U 相の、LS2 端子には V 相と W 相のローサイド出力素子のソース（エミッタ）が接続されています。LSx 端子は外部で接続し、シャント抵抗 R_S を接続します。 R_S は IC のできるだけ近くに配置し、LSx 端子と COMx 端子間に最短で接続します。また、 R_S はインダクタンス成分の小さい抵抗を使用してください。配線のインダクタンス成分は誤動作の要因になるため、インダクタンス成分が極力小さくなるようにパターンを設

SIM260xM シリーズ

計します。この配線が長い場合は、誤動作を防止するため LSx 端子と COMx 端子間に高速整流ダイオード D_{RS} を接続します。

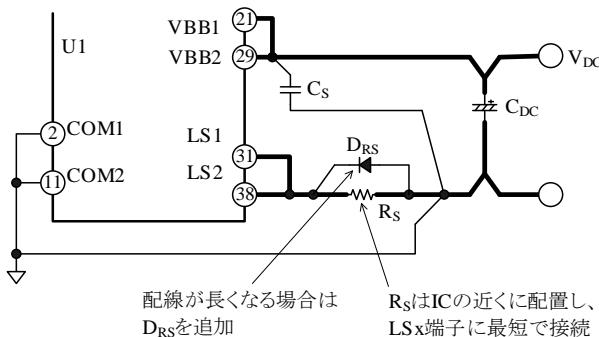


図 11-10 LSx 端子周りの配線

11.2 起動動作

VCC 端子電圧が $V_{CC(ON)} = 11.5$ V に達すると、本 IC は動作を開始します。このとき、MLP 端子、CW/CCW 端子、FGSEL 端子の設定を検出し、制御に反映します。その後、出力デューティを制御するため VSP 端子電圧を上昇させます。起動時、IC は VSP 端子電圧に応じて以下のように動作します。

• $V_{SP} < 1.0$ V

すべての出力信号はオフ状態です。

• $1.0 \leq V_{SP} < 2.1$ V

ブートストラップコンデンサの充電動作をします。詳細は 11.3 項を参照してください。

• $2.1 \leq V_{SP} \leq 5.4$ V

VSP 端子電圧に応じて出力デューティを制御します。起動時は、位置検出信号 Hx の周波数が、1.0 Hz 未満の範囲は 120°通電で駆動し、周波数が 1.0 Hz 以上（電気角 60°で位置検出信号を検出している状態）になると、180°通電信号を生成し、モータを駆動します。

表 11-4 に時計回り、表 11-5 に反時計回りの 120°通電駆動時の真理値表を示します。また、図 11-15 に時計回り（進角なし）、図 11-16 に時計回り（進角 15°）、図 11-17 に反時計回りの各端子動作波形を示します。図内の S_U 、 S_V 、 S_W と S_x 、 S_y 、 S_z は、それぞれ IC 内部で生成される信号です。設定した方向と逆に回転していると検出した場合は、電気角 60°で即座に 120°通電駆動に切り替わります。逆回転検出機能の詳細は 11.7.6 項を参照してください。

電源の起動、停止のシーケンスにおいて以下の内容には注意が必要です。

- 起動時は、必ず最後に VSP 端子の電圧を上昇させ、停止時は、必ず最初に VSP 端子の電圧を低下させてください。

- モータロック保護機能を有効（MLP = L）に設定している場合は、起動時の VBBx 端子電圧の印加タイミングに注意が必要です。起動時は、VCC 端子電圧を印加して VREG 端子電圧が上昇してから、モータロック保護検出時間以内に主電源電圧を印加し、VBBx 端子電圧を上昇させてください。モータロック保護検出時間以上経過しても、位置検出信号が変化しない場合、IC はモータがロック状態であると判断し、モータロック保護機能（11.7.5 項参照）が動作します。

本 IC は、テストモードで動作させることができます。テストモード時は、120°通電動作時のハイサイド素子のデューティは 100%、サーマルシャットダウンは無効、進角値は 0°固定です。テストモードで動作させるためには、VSP 端子電圧を 8.1 V 以上、かつ CW/CCW 端子電圧を 2.75 V (typ.) に印加した状態で、IC を起動します。

11.3 ブートストラップコンデンサの充電

起動時はブートストラップ回路用コンデンサ C_{Bx} を十分に充電する必要があります。起動時、VSP 端子電圧 V_{SP} が $1.0 \leq V_{SP} < 2.1$ V の範囲では、IC は C_{Bx} を充電するために、PWM 周期ごとにローサイドの出力素子をオンします。 V_{SP} が 2.1 V 以上になると、VSP 端子電圧に応じて速度を制御します（11.4 項参照）。ただし、 $1.0 \leq V_{SP} < 2.1$ V の範囲で、モータが設定に対して逆に回転している場合や、1.0 Hz 以上で惰性回転している場合は、 C_{Bx} を充電しません。また、起動時に VSP 端子電圧が急激に 2.1 V 以上まで上昇した場合は、9 ms ± 5% の期間、ブートストラップコンデンサを充電してから、速度制御を開始します。

11.4 速度制御

モータの回転速度は、VSP 端子に入力するアナログ電圧で制御されます。 $2.1 \text{ V} \leq V_{SP} \leq 5.4 \text{ V}$ の範囲では、VSP 端子電圧に応じて出力デューティ制御をします。 $V_{SP} < 2.1 \text{ V}$ の範囲の動作（起動動作）は、11.2 項を参照してください。

VSP 端子の電圧 V_{SP} は、7 ビット AD コンバータでデジタル変換され、この値に応じて出力信号のデューティが変化します。 V_{SP} が上昇するほどデューティが大きくなり、モータの速度も上昇します。VSP 端子電圧 V_{SP} デューティの関係を図 11-11 に示します。 V_{SP} が 5.4 V 以上の範囲では、デューティ 100%で制御します。

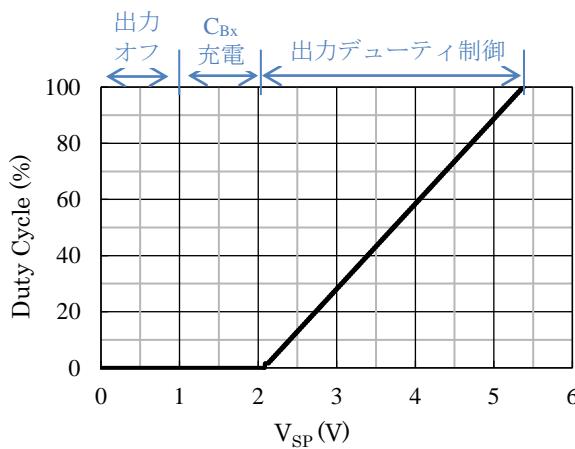


図 11-11 VSP 端子電圧とデューティの関係

VSP 端子の周辺回路と内部回路を図 11-12 に示します。VSP 端子に印加する電圧 V_{SPP} は絶対最大定格 10 V 未満になるように設定してください。 R_{SP} は 100Ω 程度、 C_{SP} は $0.1 \mu\text{F}$ 程度です。

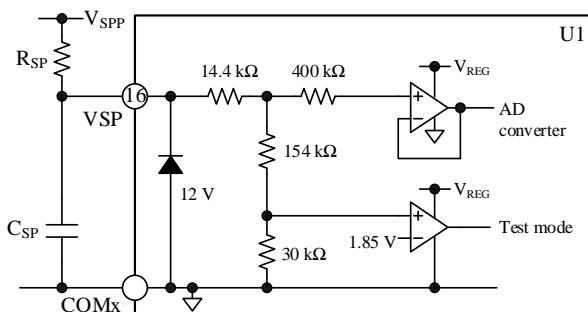


図 11-12 VSP 端子の周辺回路と内部回路図

11.5 進角機能

本 IC は進角機能を搭載しています。LA 端子に入力したアナログ電圧によって進角値が決まります。図 11-13 のように、VREG 端子電圧を抵抗 R_{LA1} 、 R_{LA2} で分圧した電圧を、LA 端子に入力します。LA 端子電圧と進角値の関係を図 11-14 に示します。進角値を設定した場合、1 相分のホール信号 4 周期ごとに $\pm 0.9375^\circ$ ずつ、設定された進角値まで変化します。

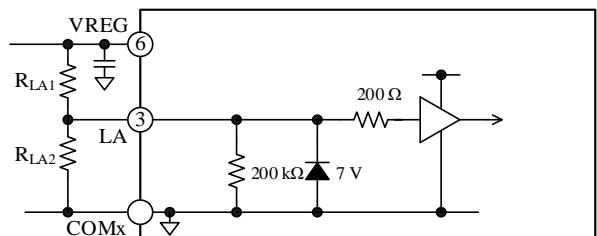


図 11-13 LA 端子の内部回路図

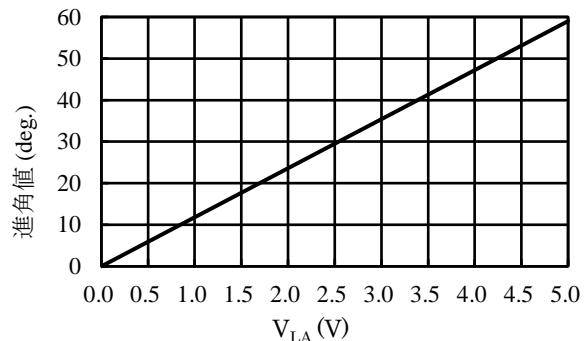


図 11-14 LA 端子電圧と進角値の関係

SIM260xM シリーズ

表 11-4 120°通電駆動時の真理値表（時計回り）

位置検出信号			U 相		V 相		W 相	
HU	HV	HW	ハイサイド 素子	ローサイド 素子	ハイサイド 素子	ローサイド 素子	ハイサイド 素子	ローサイド 素子
H	L	H	オフ	オン	オン	オフ	オフ	オフ
H	L	L	オフ	オン	オフ	オフ	オン	オフ
H	H	L	オフ	オフ	オフ	オン	オン	オフ
L	H	L	オン	オフ	オフ	オン	オフ	オフ
L	H	H	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン
L	L	H	オフ	オフ	オン	オフ	オフ	オン
L	L	L	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
H	H	H	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ

表 11-5 120°通電駆動時の真理値表（反時計回り）

位置検出信号			U 相		V 相		W 相	
HU	HV	HW	ハイサイド 素子	ローサイド 素子	ハイサイド 素子	ローサイド 素子	ハイサイド 素子	ローサイド 素子
L	H	L	オフ	オン	オン	オフ	オフ	オフ
L	H	H	オフ	オン	オフ	オフ	オン	オフ
L	L	H	オフ	オフ	オフ	オン	オン	オフ
H	L	H	オン	オフ	オフ	オン	オフ	オフ
H	L	L	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン
H	H	L	オフ	オフ	オン	オフ	オフ	オン
H	H	H	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
L	L	L	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ

SIM260xM シリーズ

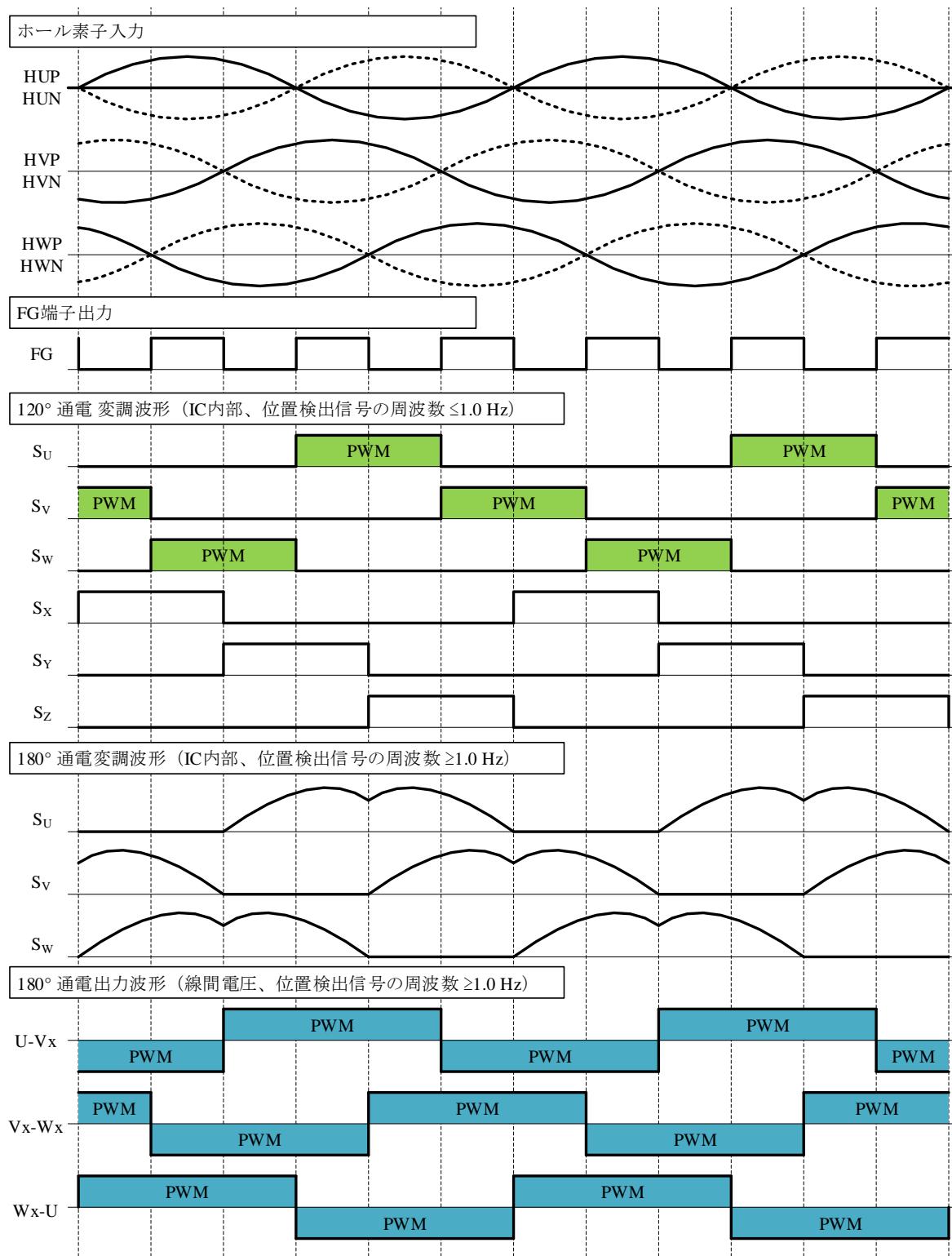


図 11-15 動作波形（時計回り、進角なし）

SIM260xM シリーズ

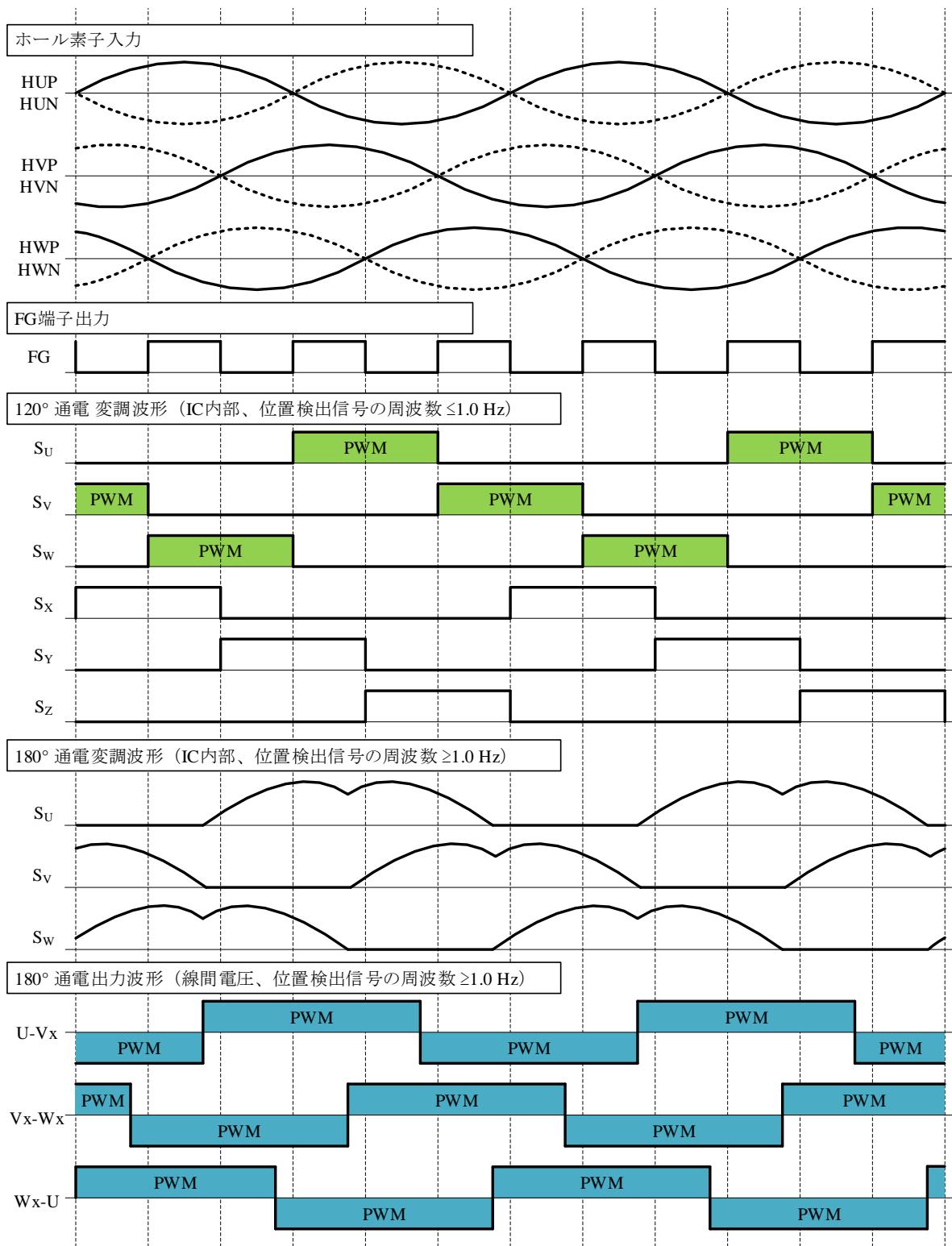


図 11-16 動作波形（時計回り、進角 15°）

SIM260xM シリーズ

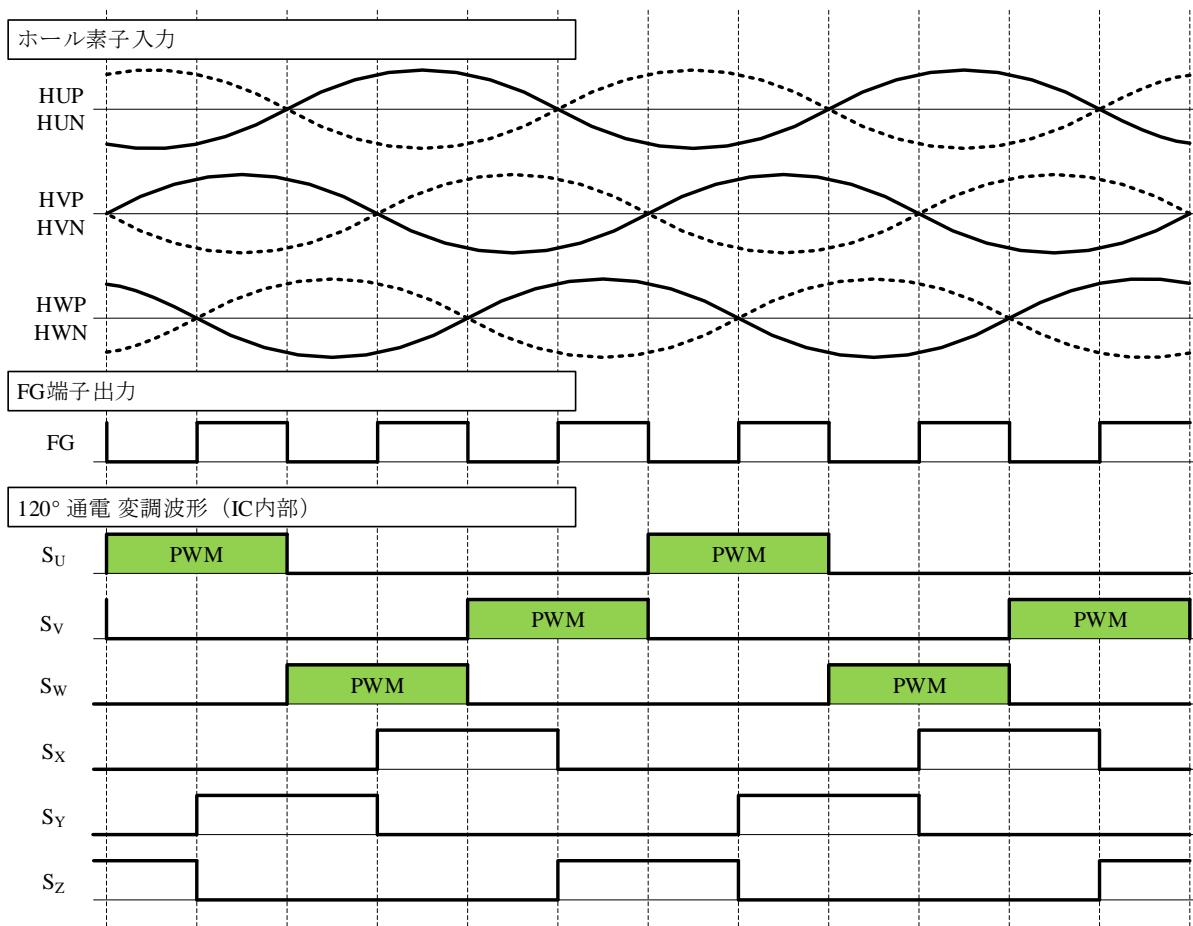


図 11-17 動作波形（反時計回り）

11.6 エラー出力

以下の保護機能が動作すると、FO 端子に接続している内部の P チャネルパワーMOSFET がオンし、FO 端子は“H”状態（約 5 V）になります。定常動作時の FO 端子は“L”状態です。

保護機能の詳細は 11.7 項を参照してください。

- VREG 端子電圧低下保護機能 (UVLO_VREG)
- 過電流保護機能 (OCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
- モータロック保護機能 (MLP)
- 逆回転検出機能
- ホール信号異常検出機能

OCP 動作時の FO 端子のエラー出力時間は、IC 内部で固定されています。 $t_P = 15 \text{ ms}$ (typ.) です (11.7.3 項参照)。エラー信号は、マイコンの割込みポート (INT) に入力し、 t_P 以内に IC への入力信号を停止するなどの処理をします。

11.7 保護機能

SIM260xM シリーズは、電源電圧の低下、過電流、モータの異常状態検出など、豊富な保護機能を搭載しています。

11.7.1 VREG 端子電圧低下保護機能 (UVLO_VREG)

VREG 端子の電圧が、 $V_{UVRL} = 3.60 \text{ V}$ 以下になると、VREG 端子電圧低下保護機能 (UVLO_VREG) が動作し、ハイサイドとローサイドの出力素子をオフにします。VREG 端子の電圧が、 $V_{UVRH} = 4.00 \text{ V}$ 以上になると、UVLO_VREG を解除します。UVLO_VREG が解除されると、ハイサイドとローサイドの出力素子は、位置検出信号に従って動作します。UVLO_VREG 動作期間は FO 端子出力が“H”になり、エラー信号を出力します。

11.7.2 電源電圧低下保護機能 (UVLO)

出力素子のゲート駆動電圧が低下すると、出力素子の定常損失が増加して熱破壊する場合があります。これを防止するために、電源電圧低下保護機能 (UVLO : Undervoltage Lockout) を搭載しています。UVLO は VBx 端子 (ハイサイド) と VCC 端子 (ローサイド) にそれぞれ搭載しています。

11.7.2.1. VBx 端子 (UVLO_VB)

VBx 端子と出力端子間 (U、V1/V2、W1/W2) の電圧 (以下 VBx-HSx 間電圧) が、 $V_{BS(OFF)} = 10.0 \text{ V}$ 以下になると UVLO_VB が動作し、ハイサイドの出力素子をオフにします。VBx-HSx 間電圧が上昇し、 $V_{BS(ON)} = 10.5 \text{ V}$ 以上になると、UVLO_VB が解除され、ハイサイドの出力素子は、位置検出信号に従って動作します。

11.7.2.2. VCC 端子 (UVLO_VCC)

VCC 端子の電圧が $V_{CC(OFF)} = 11.0 \text{ V}$ 以下になると、ハイサイドとローサイドの出力素子をオフにします。VCC 端子の電圧が上昇し、 $V_{CC(ON)} = 11.5 \text{ V}$ 以上になると、UVLO_VCC を解除します。UVLO_VCC が解除されると、ハイサイドとローサイドの出力素子は、位置検出信号に従って動作します。

11.7.3 過電流制限機能 (OCL) 、過電流保護機能 (OCP)

本 IC は、過電流制限機能 (OCL : Overcurrent Limit) と、過電流保護機能 (OCP : Overcurrent Protection) の 2 種類の過電流保護機能を搭載しています。図 11-18 に、OCP 端子の内部回路と周辺回路を示します。OCP 端子には、図 11-18 のようにシャント抵抗 R_S の電圧を OCP 端子に入力し、過電流を検出します。OCP 端子は内部でプルアップされており、 R_S に電流が流れると、電流に比例して OCP 端子電圧が上昇します。なお、 R_S がオープンの場合は、OCP が動作します。

U 端子、V1/V2 端子、W1/W2 端子やその配線がグランドと短絡 (地絡) すると、IC は過電流を検出できません。地絡モードになると出力素子が破壊する可能性があるため、注意が必要です。

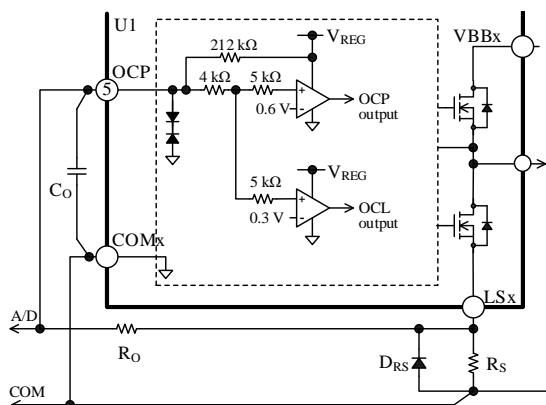


図 11-18 OCP 端子の内部回路と周辺回路

SIM260xM シリーズ

過電流制限機能（OCL）は、低い過電流レベルの保護機能です。OCP 端子電圧が $V_{LIM} = 0.30$ V 以上の状態が、ブランкиング時間 $t_{BK(OCL)} = 2.3\ \mu s$ 以上継続すると、ハイサイドとローサイドの出力素子をオフにします。OCL は、PWM 周期ごとに自動的に解除されます。

過電流保護機能（OCP）は、急峻な過大電流に対する保護です。過大電流が流れ OCP 端子の電圧が $V_{TRIP} = 0.60$ V 以上になり、その状態をブランキング時間 $t_{BK(OCP)} = 0.8\ \mu s$ 以上継続すると、OCP が動作します。OCP が動作すると、ハイサイドとローサイドの出力素子を一定時間 ($t_p = 15\ ms$) オフにします。その後、ハイサイドとローサイドの出力素子は、位置検出信号に従って動作します。OCP が動作している間は、FO 端子が“H”になり、エラー信号を出力します。

過電流保護機能の目的は、出力素子が短絡するなどの異常状態の検出です。短絡モードを繰り返すと出力素子が破壊する可能性があるため、エラー信号検出時は、すぐにマイコンでモータの運転を停止する設定にしてください。その後、IC の動作を再開させる場合は、動作停止から少なくとも 2 秒以上経過してから、再開させてください。

シャント抵抗 R_s は、以下の条件を満たすように設定します。

- シャント抵抗推奨値 R_s を満たす値（2 項参照）
- OCP 端子の入力電圧が絶対最大定格の入力電圧 $2 V_{IN(2)}$ の範囲内（1 項参照）
- 出力素子に流れる電流が絶対最大定格の出力電流（パルス） I_{OP} 未満（1 項参照）

R_s には高周波スイッチング電流が流れるので、内部インダクタンスが小さく、かつ許容損失を満足するものを使用します。

11.7.4 サーマルシャットダウン (TSD)

本 IC は、サーマルシャットダウン (TSD : Thermal Shutdown) を搭載しています。過負荷による消費電力の増加や IC 周囲温度の上昇などで IC が過熱状態になると、IC はハイサイドとローサイドの出力素子をオフにします。

温度は、ゲート駆動用 MIC 内の TSD 回路で検出しています（図 6-1 参照）。ゲート駆動用 MIC のジャンクション温度 $T_{J(DRV)}$ が $T_{DH} = 130\ ^\circ C$ (typ.) を超えると TSD が動作します。その後、 $T_{J(DRV)}$ が $T_{DH} - T_{D(HYS)}$ 以下になると TSD を解除します。TSD 解除後は入力信号に従って動作します。TSD 動作期間は FO 端子出力が“H”になり、エラー信号を出力します。ただし、出力素子のジャンクシ

ョン温度と検出温度 $T_{J(DRV)}$ は一致しないため、過熱破壊防止用として TSD 機能を使用しないでください。

11.7.5 モータロック保護機能 (MLP)

モータが駆動中に、位置検出信号が電気角で 60° 以上変化しない状態が、モータロック保護検出時間 $t_{LD} = 5\ s$ 以上継続した場合、モータロック保護機能 (MLP : Motor Lock Protection) が動作します。

MLP が動作すると、ハイサイドとローサイドの出力素子を一定時間 ($t_{LH} = 64\ s$) オフにします。その後、ハイサイドとローサイドの出力素子は、位置検出信号に従って動作します。

MLP が動作している間は、FO 端子が“H”になり、エラー信号を出力します。また、出力素子に直流電流が流れ、出力素子のジャンクション温度が上昇するため、ジャンクション温度が絶対最大定格を超えないよう注意してください。

11.7.6 逆回転検出機能

実際のモータの回転方向が、設定した回転方向と一致しない場合、逆回転検出機能が動作して FO 端子を“H”にします（エラー信号出力）。モータの回転方向が、設定した回転方向になると FO 端子は“L”になります。モータが回転している間に逆回転を検出した場合は、電気角 60° で即座に 120° 通電駆動に切り替わります。

表 11-6 逆回転検出時の駆動方式

CW/CCW 端子の設定	モータの回転方向	駆動方式
L (時計回り)	時計回り	180° 通電駆動
	反時計回り	120° 通電駆動
H (反時計回り)	時計回り	120° 通電駆動
	反時計回り	180° 通電駆動

11.7.7 ホール信号異常検出機能

本 IC は、図 11-19 のようにホール素子からの信号をコンパレータに入力し、コンパレータの出力を位置検出信号として使用します。

位置検出信号 (HU、HV、HW) が、すべて“H”、またはすべて“L”になった場合は、ホール信号異常検出機能が動作し、ハイサイドとローサイドの出力素子をオフにします。位置検出信号が上記の条件以外の入力条件になると、ハイサイドとローサイドの出力素子は位置検出信号に従って動作しま

SIM260xM シリーズ

す。位置検出信号と出力素子の真理値表は、表 11-4、表 11-5 を参照してください。ホール信号異常検出機能が動作している間は、FO 端子が“H”になり、エラー信号を出力します。

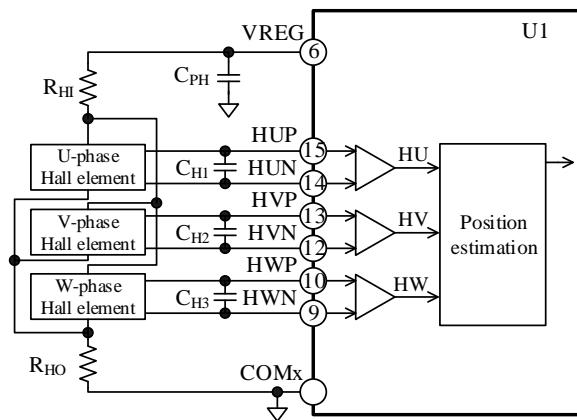


図 11-19 HxP 端子と HxN 端子の内部回路と
周辺回路

12. 設計上の注意点

12.1 パターンレイアウト

図 12-1 のようにモータドライバは、高周波かつ高電圧の電流経路が存在し、基板のパターンや部品の実装条件が、動作、ノイズ、損失などに大きく影響します。そのため、高周波電流ループは極力小さく、パターンを太くして、ラインインピーダンスを低くする必要があります。また、グランドラインは輻射ノイズに大きな影響を与えるため、極力太く、短く配線します。

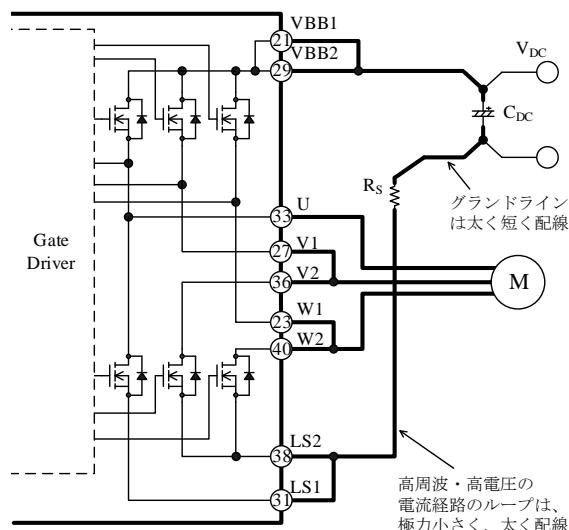


図 12-1 高周波かつ高電圧の電流経路

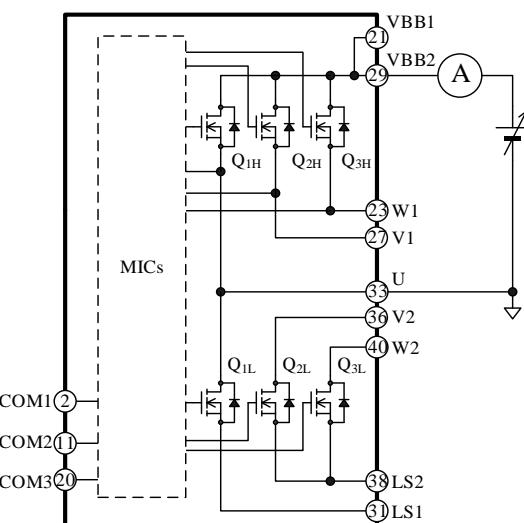
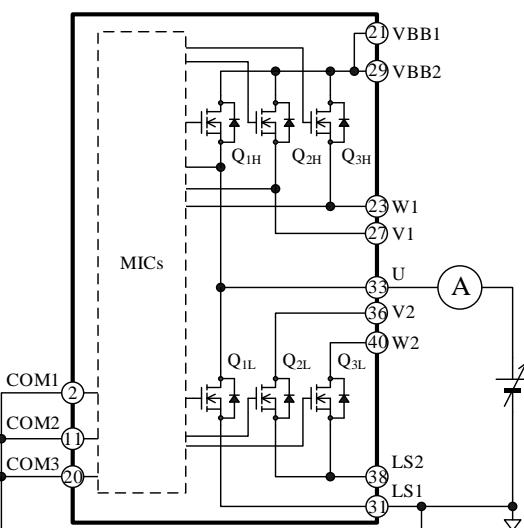
12.2 IC の特性を測定する際の注意

IC 単体で内部の出力素子のリーク電流を測定する場合、出力端子（U, V1, V2, W1, W2）や LSx 端子、COMx 端子を適切に処理しないと、出力素子を破壊する可能性があるため、注意が必要です。リーク電流を測定するときは、各出力素子のゲートとソース（エミッタ）を同電位にする必要があります。また、各出力素子は、IC 内部で以下のように接続されているため、注意が必要です。

- すべてのハイサイド出力素子のドレイン（コレクタ）は、IC 内部で VBBx 端子に接続
- U 相のハイサイド出力素子のソース（エミッタ）とローサイド出力素子のドレイン（コレクタ）は、IC 内部で U 端子に接続（V 相と W 相のハイサイドとローサイドの出力素子は、IC 内部で接続されていません。）
- V 相と W 相のローサイド出力素子のソース（エミッタ）は、IC 内部で LS2 端子に接続

- ハイサイド出力素子のゲートは、IC 内部で出力端子にプルダウン
- ローサイド出力素子のゲートは、IC 内部で COMx 端子にプルダウン

例として、図 12-2 に U 相ハイサイド出力素子（Q_{1H}）、図 12-3 に U 相ローサイド出力素子（Q_{1L}）の測定回路を示します。記載のない端子はすべてオープンです。ハイサイドの出力素子を測定する場合は、測定する端子以外はすべてオープンにします。ローサイドの出力素子を測定する場合は、測定する LSx 端子だけを COMx 端子に接続し、それ以外はオープンにします。

図 12-2 U 相ハイサイド出力素子 (Q_{1H}) リーク電流測定回路図 12-3 U 相ローサイド出力素子 (Q_{1L}) リーク電流測定回路

12.3 放熱器を取り付ける際の注意

放熱器を取り付ける際には以下の注意が必要です。

- φ6.0 平座金と M2.5 ネジを使用してください。ネジ締めの際は、トルクドライバを使用し、4 項機械的特性の締付けトルクの範囲で固定してください。固定する際は、片締めにならないように、2か所のネジを仮締めしてから、左右均等に締め付けてください。
- 放熱器を取り付ける場合はシリコーングリースの使用を推奨します。放熱シート、絶縁シートは締付け時にしわが発生し、パッケージが割れる原因になるため、これらを使用する際には、十分な検討が必要です。
- シリコーングリースを塗布する際は、放熱器と IC の間に異物がないことを確認してください。また、製品の端子に極力付着しないように注意が必要です。シリコーングリースの塗布条件は以下のとおりです。
 - 塗布厚 : 100 μm
 - 放熱器の平坦度 : ±100 μm
 - 放熱器に塗布する場合の塗布範囲は図 12-4 参照

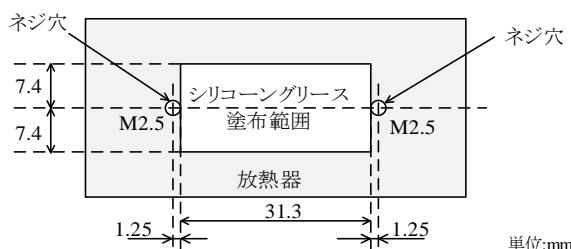


図 12-4 シリコーングリースの塗布範囲 (参考)

13. 損失の計算とジャンクション温度の推定

正弦波駆動、3 相変調方式において、出力素子(全素子)の損失とジャンクション温度の推定方法を以下に示します。なお、損失とジャンクション温度は、弊社 HP に掲載している計算ツールを用いて簡単に計算できます。

- DT0050 SIM2601MA 損失計算ツール
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/calc-tool/mosfet_caltool_jp.html
- DT0052 SIM2602M 損失計算ツール
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/calc-tool/igbtall_caltool_jp.html

13.1 パワーMOSFET の場合

パワーMOSFET の損失は、定常損失 P_{RON} 、スイッチング損失 P_{SW} とボディーダイオードの定常損失 P_{SD} の合計です。ここで P_{RR} は他の損失に対して割合が小さいため無視できるものとします。

損失 (P_{RON} , P_{SW} , P_{SD}) とジャンクション温度(全素子動作時)は、以下の手順で算出します。

13.1.1 パワーMOSFET の定常損失 P_{RON}

パワーMOSFET の定常損失 P_{ON} は、14.3.1 項の $R_{DS(ON)} - I_D$ 特性より、図 13-1 のように I_D の使用範囲における 1 次近似式 ($R_{DS(ON)} = \alpha \times I_D + \beta$) を算出します。パワーMOSFET の定常損失 P_{RON} は、この 1 次近似式の係数を用いて、次式で計算できます。

$$P_{RON} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_D(\varphi)^2 \times R_{DS(ON)}(\varphi) \times DT \times d\varphi$$

$$= 2\sqrt{2}\alpha \left(\frac{1}{3\pi} + \frac{3}{32}M \times \cos\theta \right) I_M^3$$

$$+ 2\beta \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{3\pi}M \times \cos\theta \right) I_M^2 \quad (1)$$

ここで、

I_D : パワーMOSFET のドレイン電流(A)

$R_{DS(ON)}$: パワーMOSFET のオン抵抗(Ω)

DT : オンデューティ

$$DT = \frac{1 + M \times \sin(\varphi + \theta)}{2}$$

M : 変調率(0~1)

$\cos\theta$: モータ力率(0~1)

I_M : モータ電流実効値(A)

α : $R_{DS(ON)} - I_D$ 特性の 1 次近似式の傾き

β : $R_{DS(ON)} - I_D$ 特性の 1 次近似式の切片

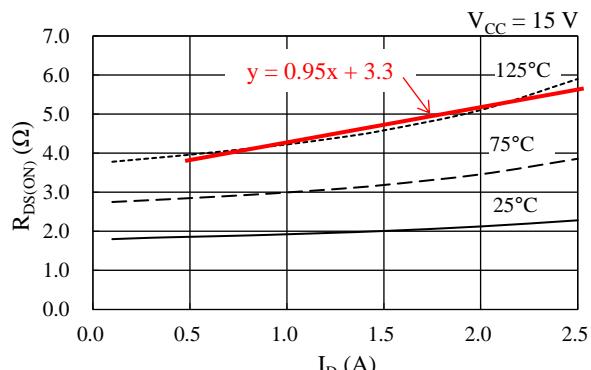


図 13-1 $R_{DS(ON)} - I_D$ 特性の 1 次近似式

SIM260xM シリーズ

13.1.2 パワーMOSFET のスイッチング損失 P_{SW}

モータの実効電流が I_M のときの、パワーMOSFET のスイッチング損失 P_{SW} は、次式で算出できます。

$$P_{SW} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times f_C \times \alpha_E \times I_M \times \frac{V_{DC}}{300} \quad (2)$$

ここで、

f_C : PWM キャリア周波数(Hz)

V_{DC} : 主電源電圧(V)

(VBBx 端子入力電圧)

α_E : スイッチング損失グラフの傾き

(14.3.2 項スイッチング損失参照)

13.1.3 ボディーダイオードの定常損失 P_{SD}

パワーMOSFET のボディーダイオードの定常損失 P_{SD} は、14.3.1 項の V_{SD} の I_{SD} 特性より、図 13-2 のように I_{SD} の使用範囲における 1 次近似式 ($V_{SD} = \alpha \times I_{SD} + \beta$) を算出します。

パワーMOSFET のボディーダイオードの定常損失 P_{SD} は、この 1 次近似式の係数を用いて、次式で計算できます。

$$P_{SD} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{SD}(\varphi) \times I_{SD}(\varphi) \times (1 - DT) \times d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \alpha \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3\pi} M \times \cos \theta \right) I_M^2 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \beta \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} M \times \cos \theta \right) I_M \quad (3)$$

ここで、

V_{SD} : ボディーダイオードの順電圧(V)

I_{SD} : ボディーダイオードの順電流(A)

DT : オンデューティ

$$DT = \frac{1 + M \times \sin(\varphi + \theta)}{2}$$

M : 変調率(0~1)

$\cos\theta$: モータ力率(0~1)

I_M : モータ電流実効値(A)

α : $V_{SD} - I_{SD}$ 特性の 1 次近似式の傾き

β : $V_{SD} - I_{SD}$ 特性の 1 次近似式の切片

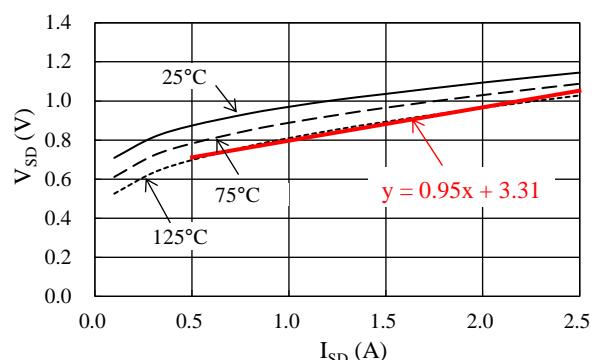


図 13-2 $V_{SD} - I_{SD}$ 特性の 1 次近似式

13.1.4 パワーMOSFET のジャンクション 温度の推定

全素子動作時のパワーMOSFET のジャンクション温度 T_J は次式で推定できます。

$$T_J = R_{J-C} \times \{(P_{ON} + P_{SW} + P_{SD}) \times 6\} + T_C \quad (4)$$

ここで、

R_{J-C} : 全素子動作時のパワーMOSFET 製品のジャンクション-ケース間熱抵抗

T_C : ケース温度(°C) (測定位置は図 3-2 参照)

13.2 IGBT の場合

IGBT の損失は、定常損失 P_{ON} とスイッチング損失 P_{SW} の合計です。これらの損失 (P_{ON} , P_{SW}) と、ジャンクション温度（全素子動作時）は、以下の手順で算出します。

13.2.1 IGBT の定常損失 P_{ON}

定常損失 P_{ON} は、14.3.1 項の $V_{CE(SAT)} - I_C$ 特性より、図 13-3 のように I_C の使用範囲における 1 次近似式 ($V_{CE(SAT)} = \alpha \times I_C + \beta$) を算出します。IGBT の定常損失 P_{ON} は、この 1 次近似式の係数を用いて、次式で計算できます。

$$P_{ON} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{CE(SAT)}(\varphi) \times I_C(\varphi) \times DT \times d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3\pi} M \times \cos \theta \right) I_M^2 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \beta \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} M \times \cos \theta \right) I_M \quad (5)$$

ここで、

$V_{CE(SAT)}$: IGBT のコレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)

I_C : IGBT のコレクタ電流(A)

DT : オンデューティ

$$DT = \frac{1 + M \times \sin(\varphi + \theta)}{2}$$

M : 変調率(0~1)

$\cos\theta$: モータ力率(0~1)

I_M : モータ電流実効値(A)

α : $V_{CE(SAT)} - I_C$ 特性の 1 次近似式の傾き

β : $V_{CE(SAT)} - I_C$ 特性の 1 次近似式の切片

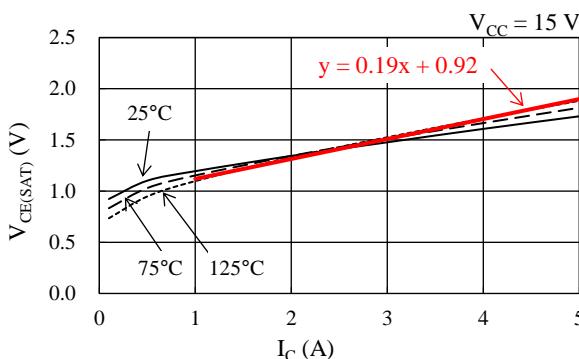


図 13-3 $V_{CE(SAT)} - I_C$ 特性の 1 次近似式

13.2.2 IGBT のスイッチング損失 P_{SW}

モータの実効電流が I_M のときの IGBT のスイッチング損失 P_{SW} は、次式で算出できます。

$$P_{SW} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times f_C \times \alpha_E \times I_M \times \frac{V_{DC}}{300} \quad (6)$$

ここで、

f_C : PWM キャリア周波数(Hz)

V_{DC} : 主電源電圧(V) (VBBx 端子入力電圧)

α_E : スイッチング損失グラフの傾き

(14.3.2 項スイッチング損失参照)

13.2.3 IGBT のジャンクション温度の推定

全素子動作時の IGBT のジャンクション温度 T_J は次式で推定できます。

$$T_J = R_{(J-C)Q} \times \{(P_{ON} + P_{SW}) \times 6\} + T_C \quad (7)$$

ここで、

$R_{(J-C)Q}$: IGBT 全素子動作時のジャンクション-ケース間熱抵抗(°C/W)

T_C : ケース温度(°C) (測定位置は図 3-2 参照)

14. 代表特性グラフ

14.1 過渡熱抵抗特性グラフ

以下に、ジャンクション-ケース間の定常熱抵抗を 1 とした場合の過渡熱抵抗（過渡熱抵抗比率）を示します。IGBT を搭載した製品の過渡熱抵抗は、IGBT のみの特性で FRD の特性は含まれていません。

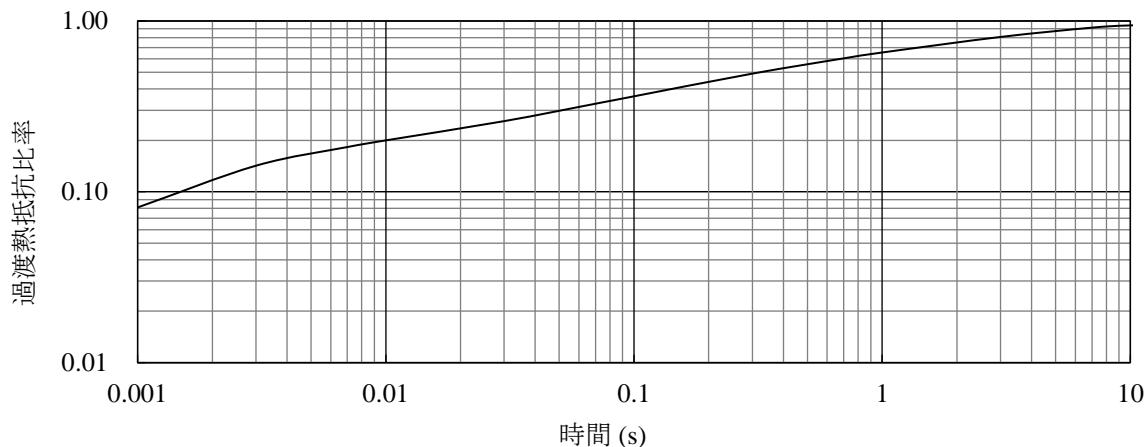


図 14-1 SIM2601MA 過渡熱抵抗比率

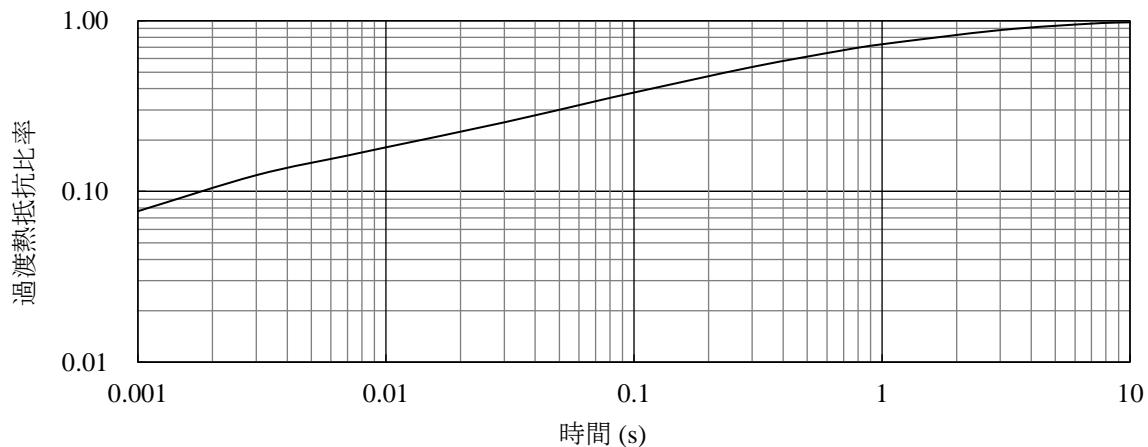


図 14-2 SIM2602M 過渡熱抵抗比率

14.2 制御部代表特性グラフ

図 14-3～図 14-19 に制御部の各種依存性および温度特性を示します。 T_J は制御部のジャンクション温度です。

表 14-1 制御部代表特性一覧

図番号	表題
図 14-3	制御電源電流 I_{CC} 温度特性
図 14-4	VCC 端子電圧 V_{CC} - 制御電源電流 I_{CC} 特性
図 14-5	制御電源電流（1相） I_{BS} 温度特性 ($V_{SP} = 0\text{ V}$)
図 14-6	制御電源電流（1相） I_{BS} 温度特性 ($V_{SP} = 5.5\text{ V}$)
図 14-7	ハイサイド制御動作開始電圧 $V_{BS(ON)}$ 温度特性
図 14-8	ハイサイド制御動作停止電圧 $V_{BS(OFF)}$ 温度特性
図 14-9	ローサイド制御動作開始電圧 $V_{CC(ON)}$ 温度特性
図 14-10	ローサイド制御動作停止電圧 $V_{CC(OFF)}$ 温度特性
図 14-11	UVLO_VB フィルタ時間温度特性
図 14-12	UVLO_VCC フィルタ時間温度特性
図 14-13	ハイレベル入力電流 1 温度特性 (LA、MLP、CW/CCW、FGSEL、VSP 端子)
図 14-14	ハイレベル入力電流 2 温度特性 (OCP 端子)
図 14-15	VREG 端子電圧 V_{REG} 温度特性
図 14-16	電流リミッタ基準電圧 V_{LIM} 温度特性
図 14-17	電流リミッタブランкиング時間 $t_{BK(OCL)}$ + 内部遅延時間 t_D 温度特性
図 14-18	過電流保護動作電圧 V_{TRIP} 温度特性
図 14-19	過電流保護保持時間 t_P 温度特性

SIM260xM シリーズ

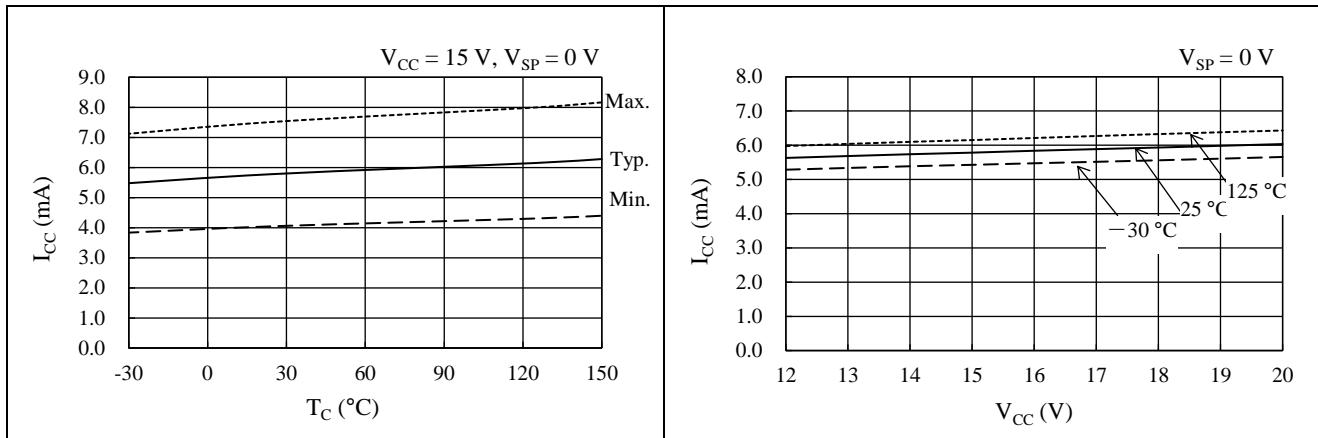


図 14-3 制御電源電流 I_{CC} 温度特性

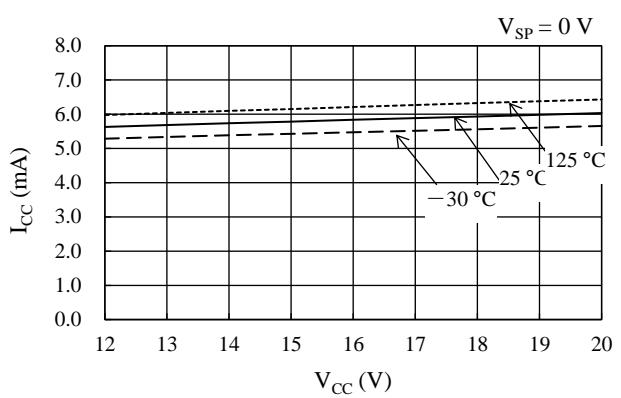


図 14-4 V_{CC} 端子電圧 V_{CC} – 制御電源電流 I_{CC} 特性

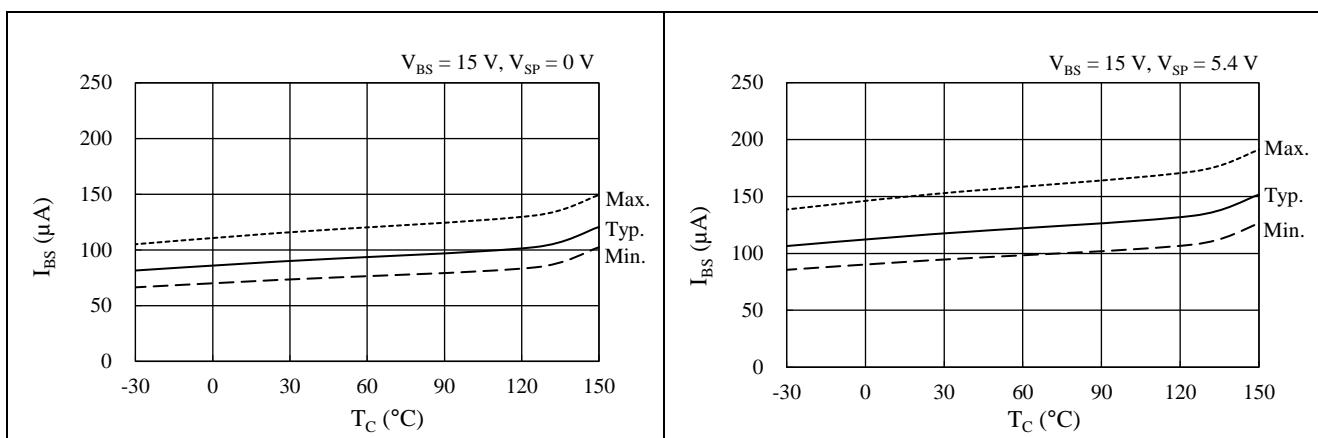


図 14-5 制御電源電流（1 相） I_{BS} 温度特性
($V_{SP} = 0\text{ V}$)

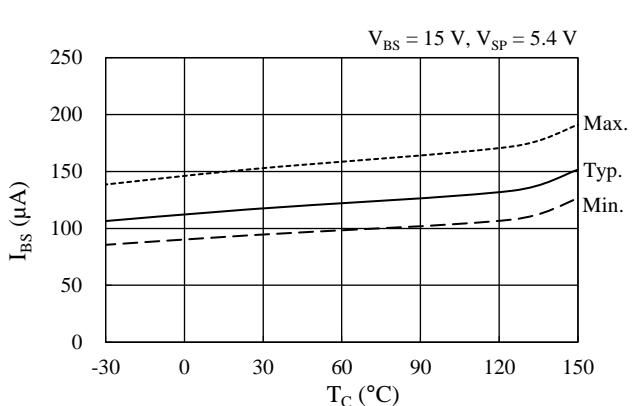


図 14-6 制御電源電流（1 相） I_{BS} 温度特性
($V_{SP} = 5.5\text{ V}$)

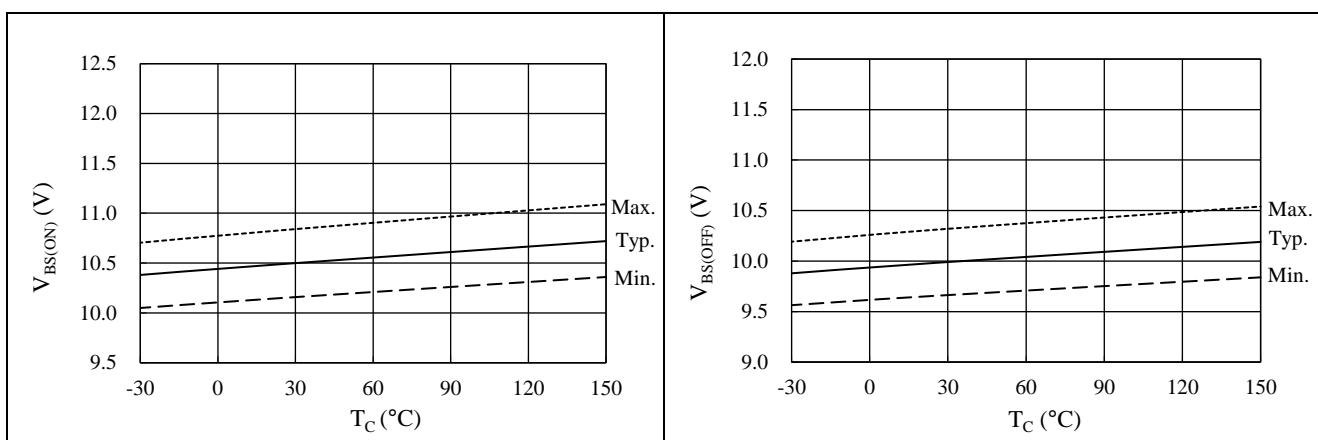


図 14-7 ハイサイド制御動作開始電圧 $V_{BS(ON)}$ 温度特性

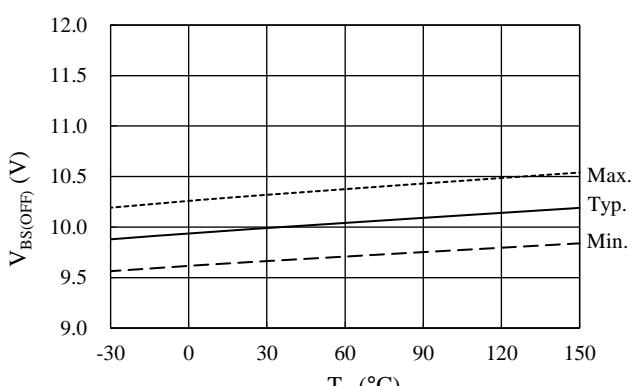


図 14-8 ハイサイド制御動作停止電圧 $V_{BS(OFF)}$ 温度特性

SIM260xM シリーズ

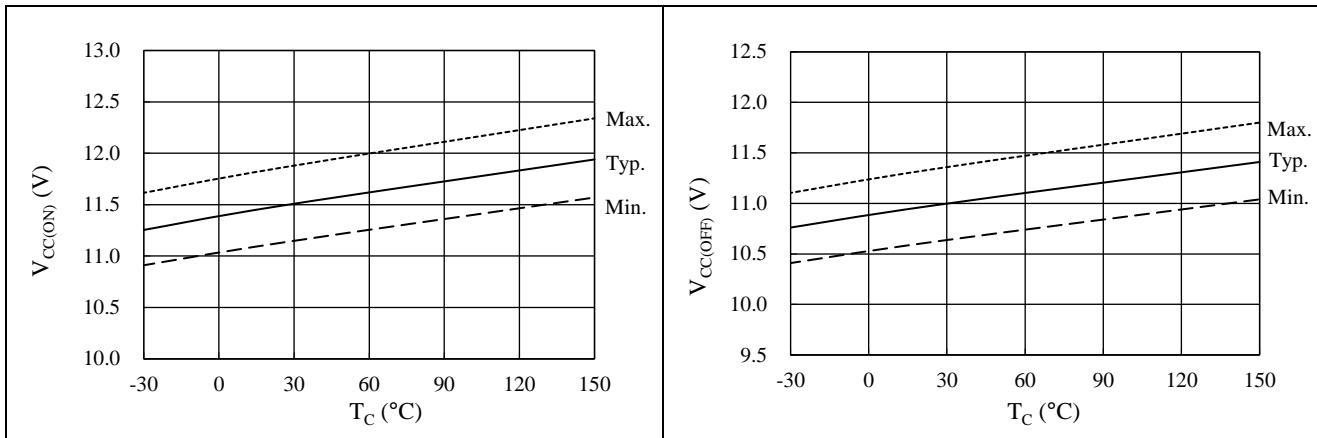


図 14-9 ローサイド制御動作開始電圧 $V_{CC(ON)}$ 温度特性

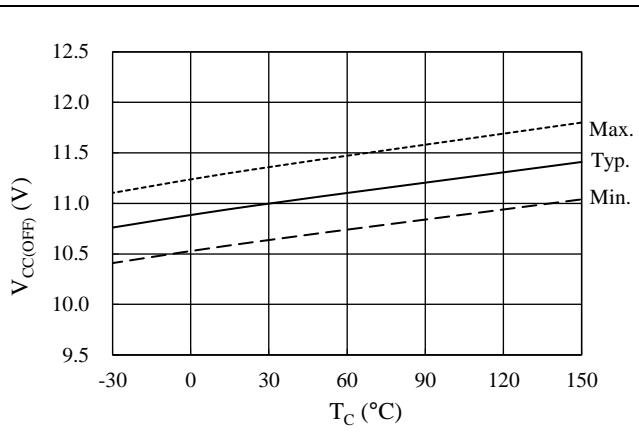


図 14-10 ローサイド制御動作停止電圧 $V_{CC(OFF)}$ 温度特性

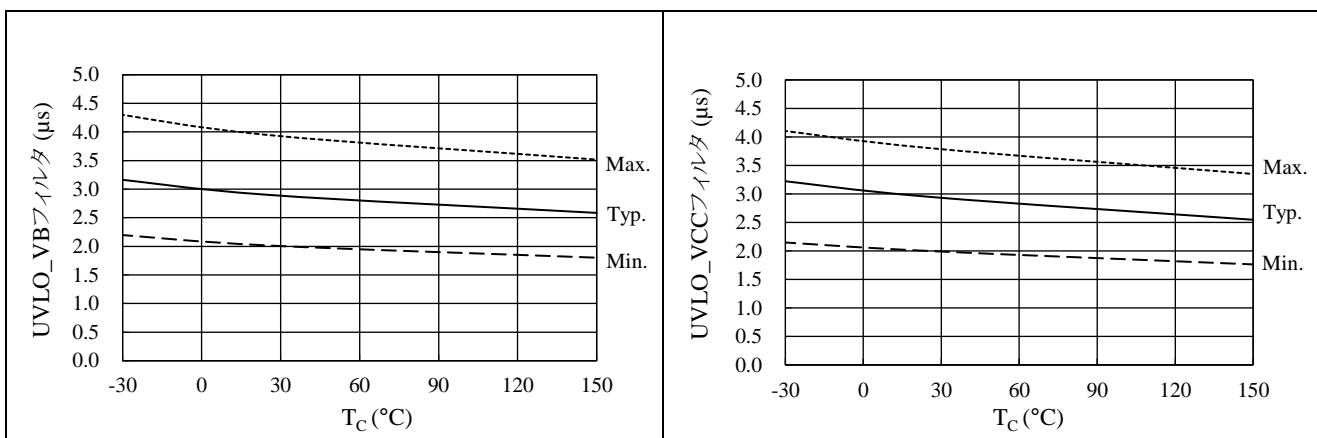


図 14-11 UVLO_VB フィルタ時間温度特性

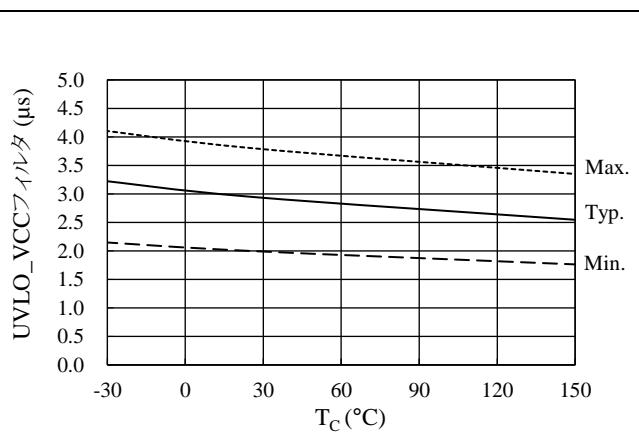


図 14-12 UVLO_VCC フィルタ時間温度特性

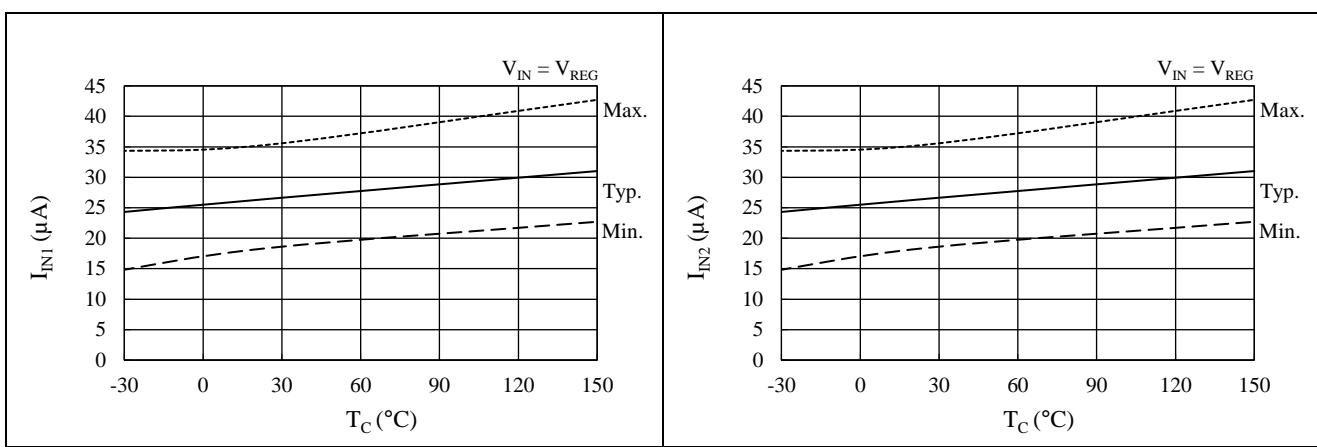


図 14-13 ハイレベル入力電流 1 温度特性 (LA、MLP、CW/CCW、FGSEL、VSP 端子)

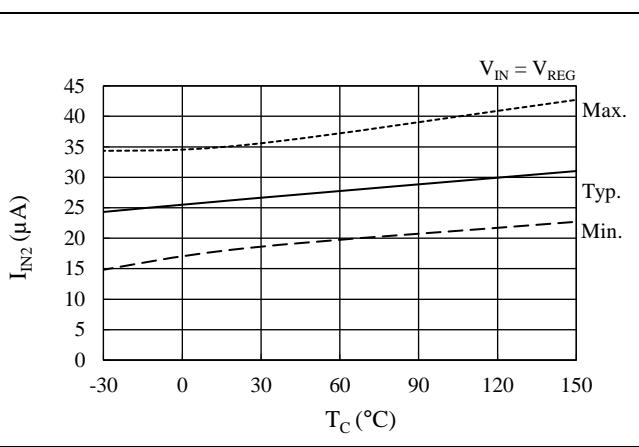


図 14-14 ハイレベル入力電流 2 温度特性 (OCP 端子)

SIM260xM シリーズ

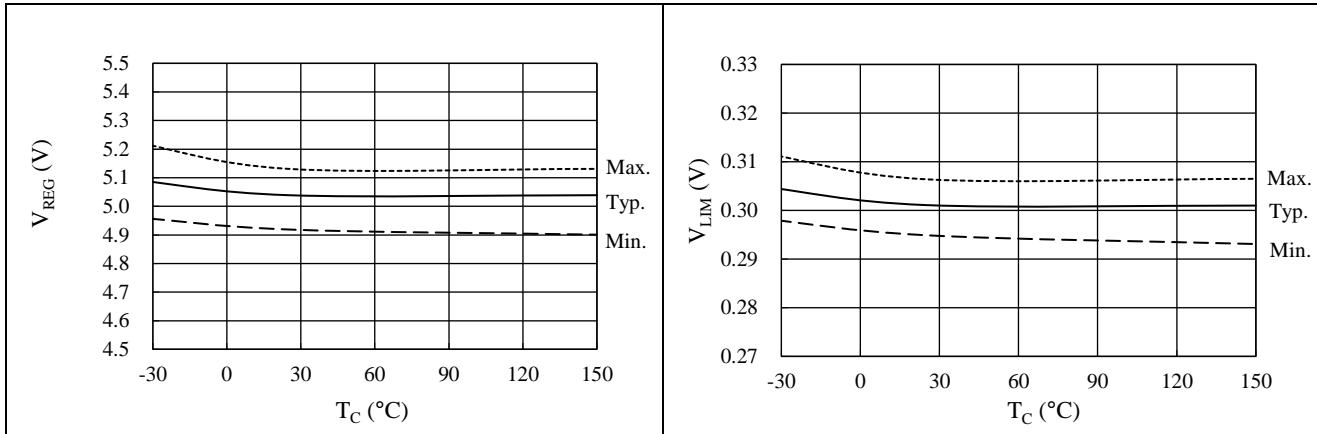


図 14-15 VREG 端子電圧 V_{REG} 温度特性

図 14-16 電流リミッタ基準電圧 V_{LIM} 温度特性

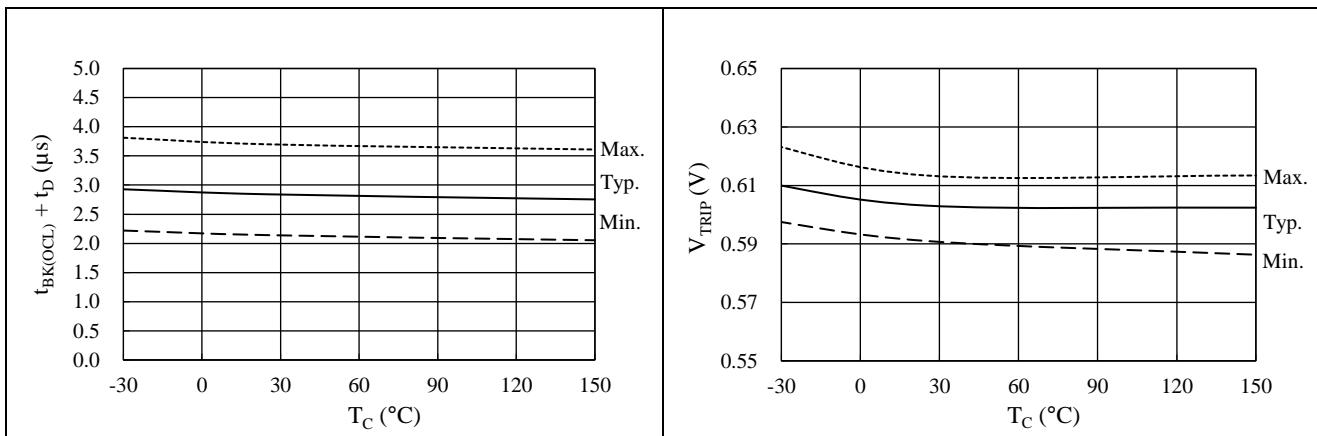


図 14-17 電流リミッタプランギング時間 $t_{BK(OCL)}$ + 内部遅延時間 t_D 温度特性

図 14-18 過電流保護動作電圧 V_{TRIP} 温度特性

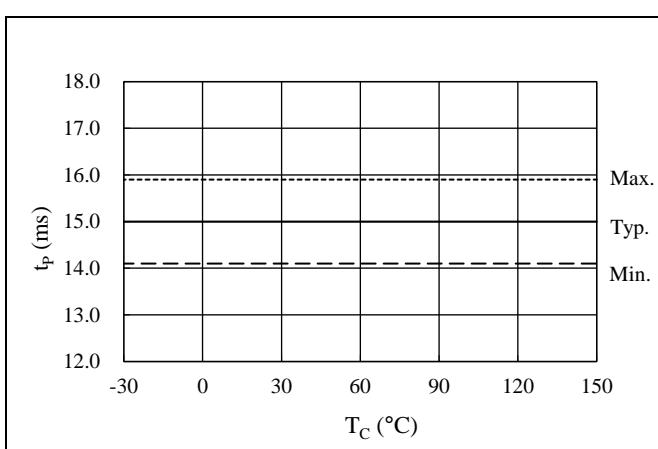


図 14-19 過電流保護保持時間 t_P 温度特性

14.3 出力特性グラフ

14.3.1 出力素子特性グラフ

14.3.1.1. SIM2601MA

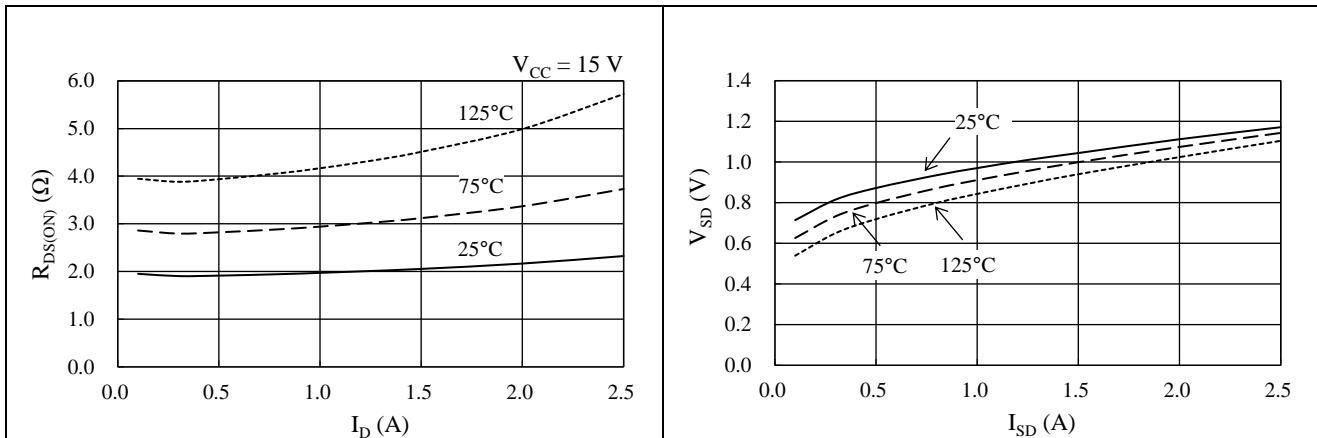


図 14-20 パワーモノラボット $R_{DS(ON)}$ - I_D 特性

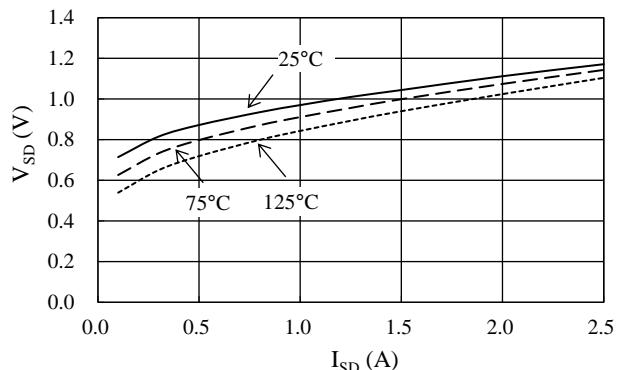


図 14-21 パワーモノラボット V_{SD} - I_{SD} 特性

14.3.1.2. SIM2602M

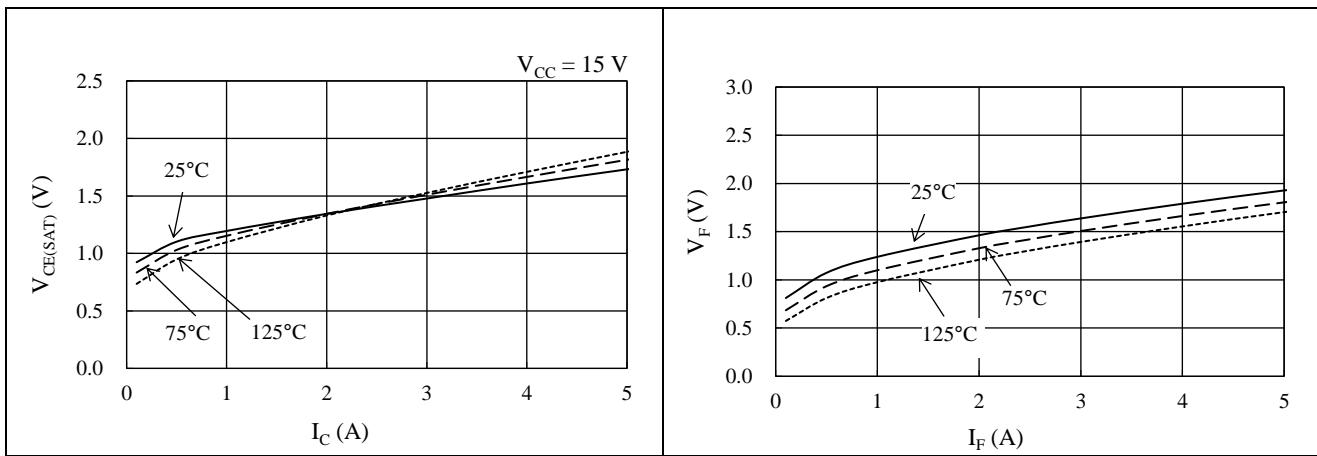


図 14-22 IGBT $V_{CE(SAT)}$ - I_C 特性

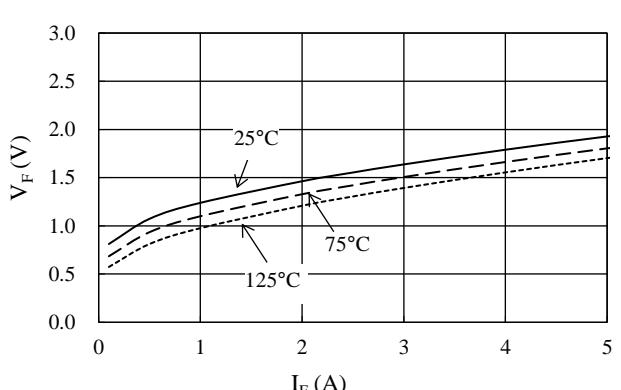


図 14-23 フリー・ホイール・ダイオード V_F - I_F 特性

SIM260xM シリーズ

14.3.2 スイッチング損失特性グラフ

V_{Bx} 端子電圧 = 300 V、L 負荷におけるハーフブリッジ動作時のスイッチング損失です。
スイッチング損失 E は、ターンオン損失とターンオフ損失の合計です。

14.3.2.1. SIM2601MA

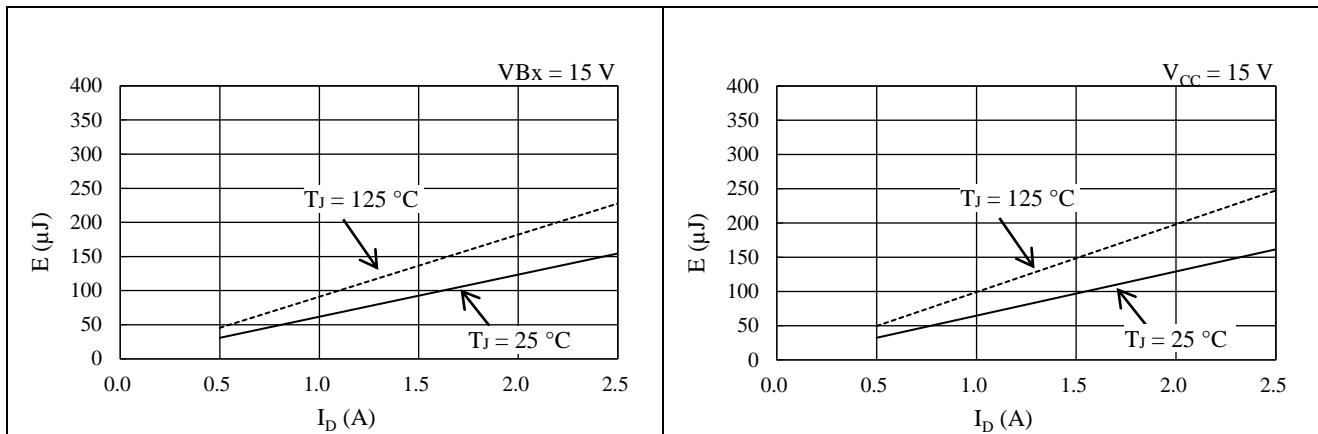


図 14-24 ハイサイドスイッチング損失特性

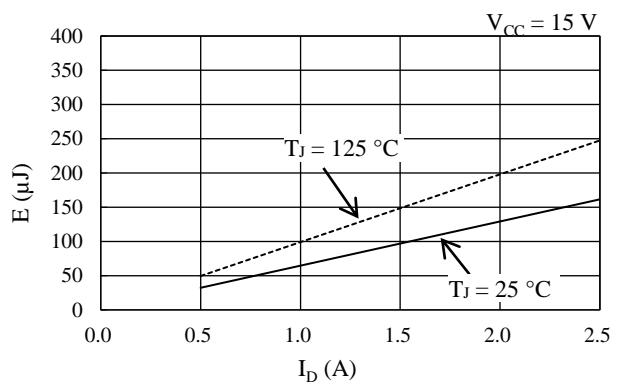


図 14-25 ローサイドスイッチング損失特性

14.3.2.2. SIM2602M

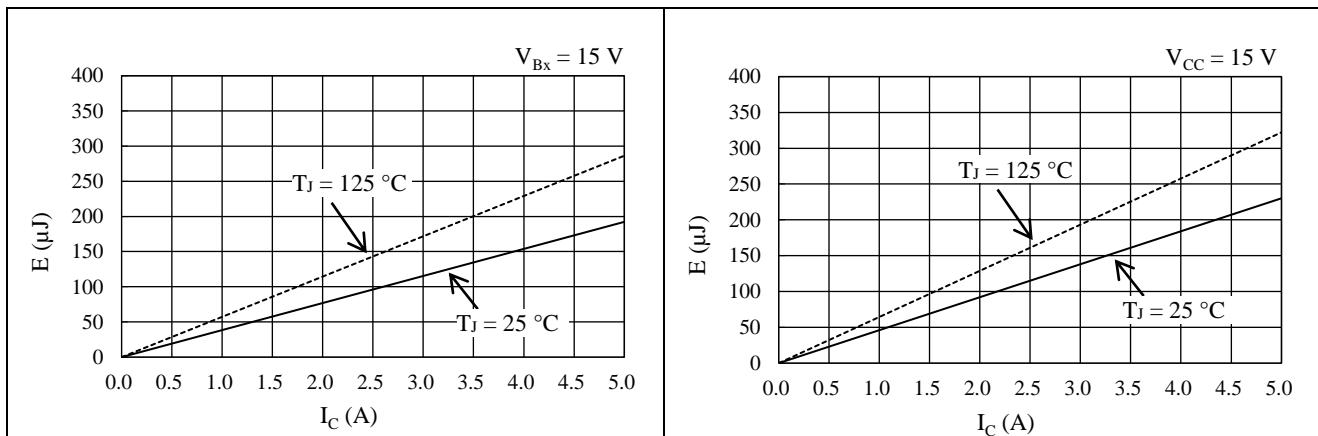


図 14-26 ハイサイドスイッチング損失特性

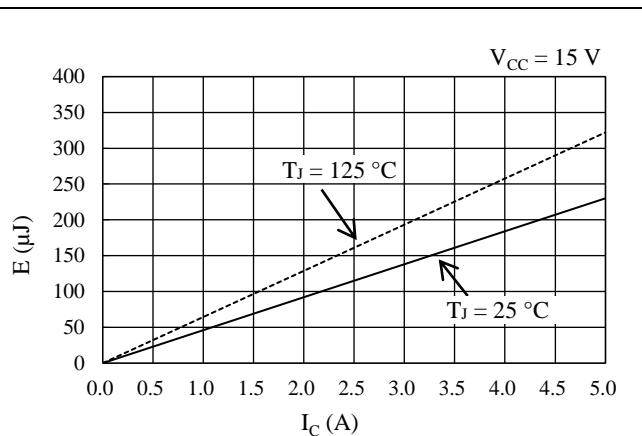


図 14-27 ローサイドスイッチング損失特性

14.4 許容実効電流特性グラフ

以下に示す許容実効電流特性は、正弦波駆動の3相変調方式、出力素子の $R_{DS(ON)}$ または $V_{CE(SAT)}$ 、およびスイッチング損失は Typ. 品を想定しています。

<動作条件>

VBBx 端子入力電圧 $V_{DC} = 300$ V、VCC 端子入力電圧 $V_{CC} = 15$ V、変調率 $M = 0.9$ 、モータ力率 $\cos\theta = 0.8$ 、ジャンクション温度 $T_J = 150$ °C

14.4.1 SIM2601MA

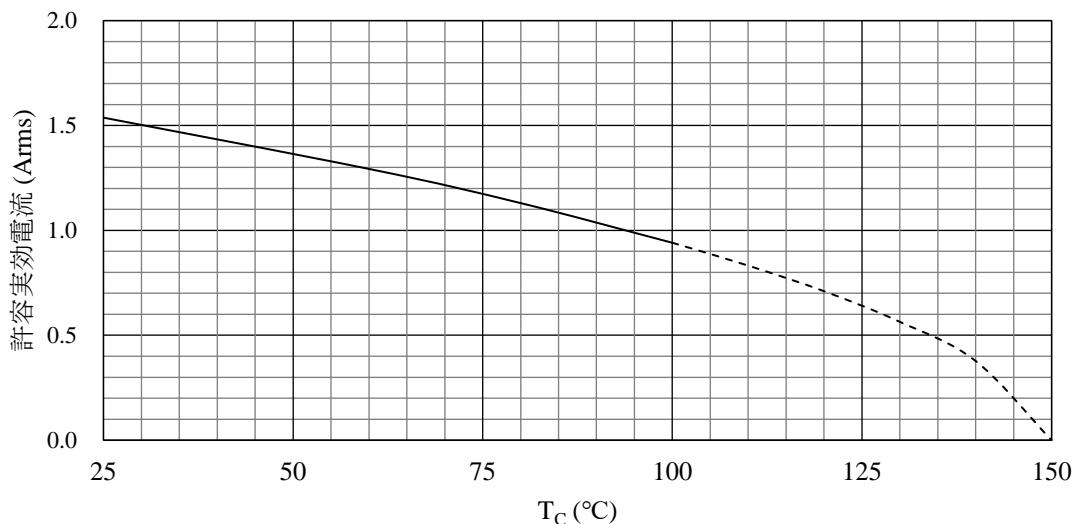


図 14-28 SIM2601MA 許容電流特性 ($f_C = 17$ kHz)

14.4.2 SIM2602M

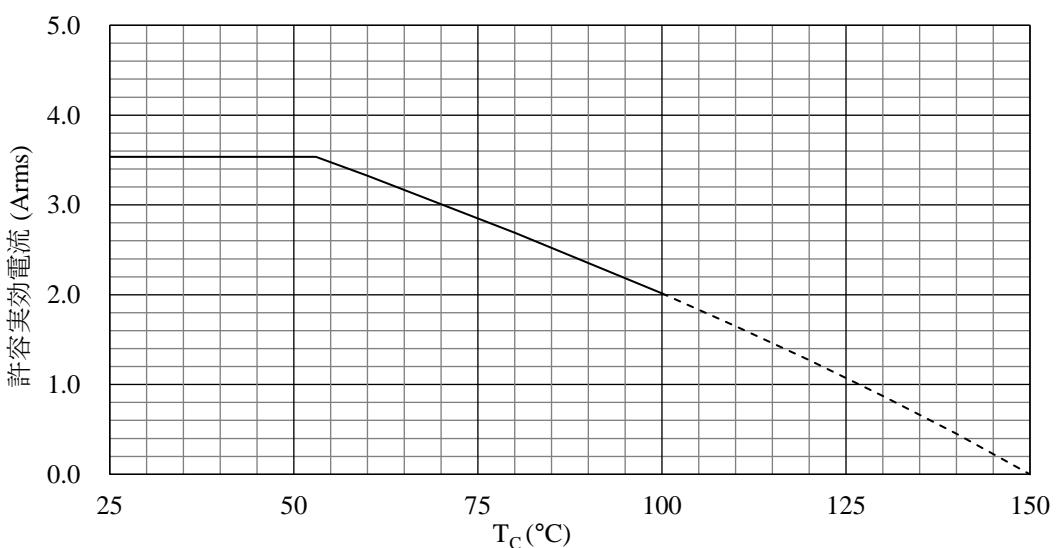


図 14-29 SIM2602M 許容電流特性 ($f_C = 17$ kHz)

14.5 短絡 SOA

以下に出力素子に IGBT を内蔵している SIM2602M の短絡 SOA を示します。

条件) $V_{DC} \leq 400$ V、 13.5 V $\leq V_{CC} \leq 16.5$ V、 $T_J = 125$ °C、1 パルス

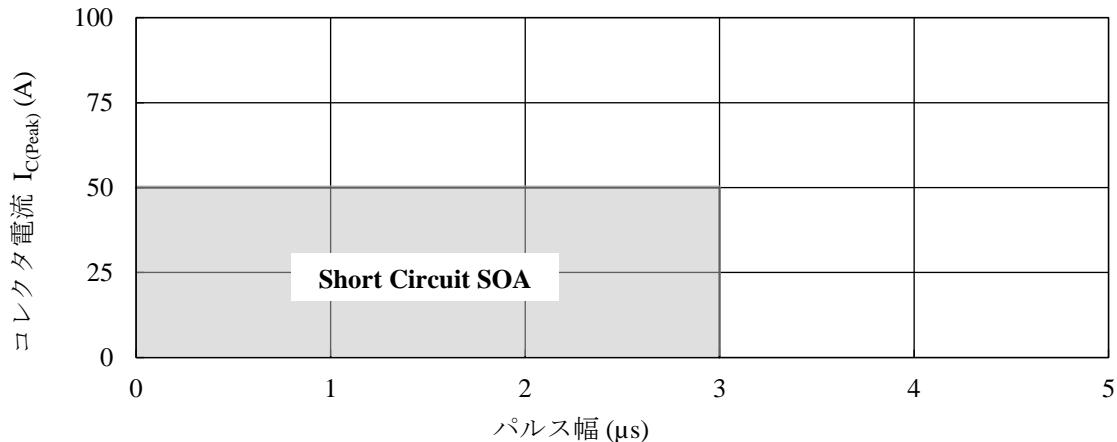
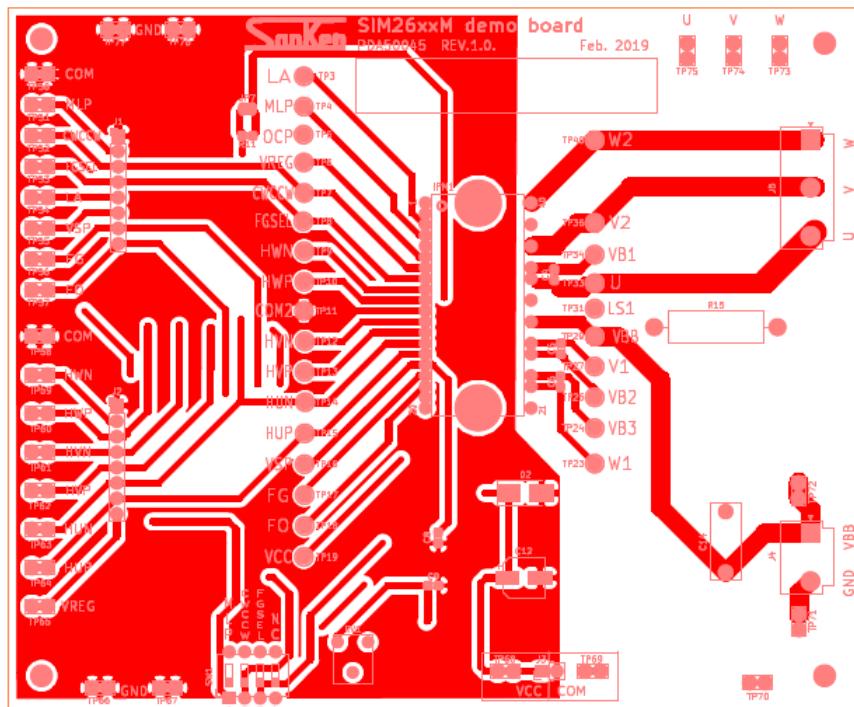


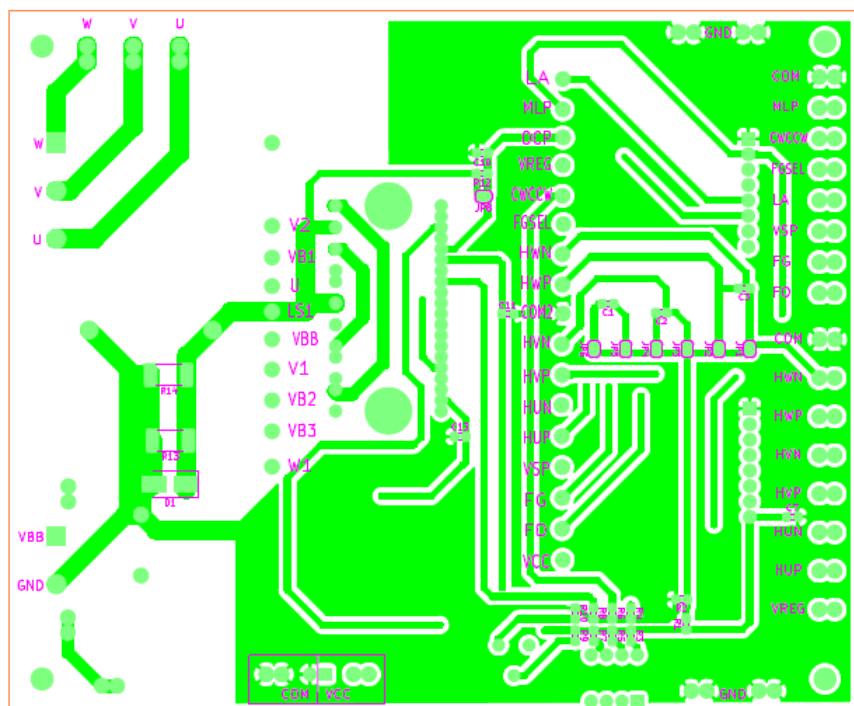
図 14-30 SIM2602M 短絡 SOA

15. パターンレイアウト例

以下に、SIM260xM シリーズを使用したパターンレイアウト例と、その回路図を示します。本 IC の
フットパターは、9 項を参照してください。



(上面)



(裏面)

図 15-1 パターンレイアウト例

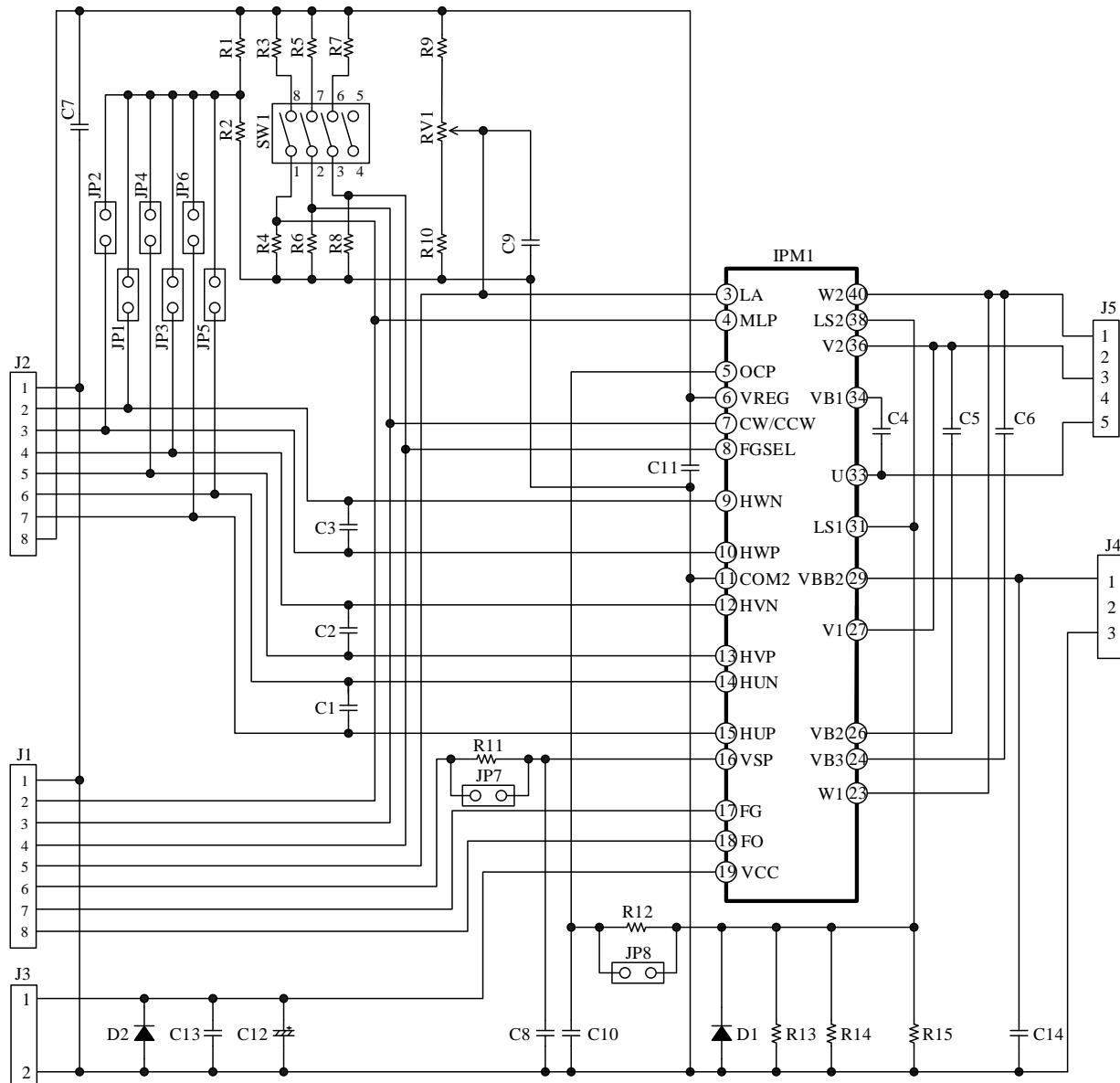


図 15-2 パターンレイアウト回路図

16. モータドライバ回路例

ホール素子の信号を入力する場合のモータドライバの回路例として、その仕様と回路図および部品表を以下に示します。

● モータドライバ仕様

使用 IC	SIM2602M
主電源電圧 V_{DC}	DC 300 V (typ.)
定格出力電力	150 W

● 回路図

図 15-2 参照

● 部品表

記号	部品名	定格	記号	部品名	定格
C1 ⁽¹⁾	Ceramic	Open	R6	General	Open
C2 ⁽¹⁾	Ceramic	Open	R7	General	Short
C3 ⁽¹⁾	Ceramic	Open	R8	General	Open
C4	Ceramic	1 μ F、 35 V	R9	General	Short
C5	Ceramic	1 μ F、 35 V	R10	General	1 k Ω 、 0.25 W
C6	Ceramic	1 μ F、 35 V	R11 ⁽²⁾	General	Open
C7	Ceramic	0.1 μ F、 35 V	R12	General	100 Ω 、 0.25 W
C8	Ceramic	0.1 μ F、 35 V	R13	Metal plate	0.33 Ω 、 1 W
C9	Ceramic	0.1 μ F、 35 V	R14	Metal plate	0.33 Ω 、 1 W
C10	Ceramic	2200 pF、 35 V	R15	Metal plate	Open
C11	Ceramic	0.1 μ F、 35 V	RV1	Trimmer	10 k Ω 、 0.25 W
C12	Electrolytic	100 μ F、 35 V	SW1	Switch	1 × 04
C13	Ceramic	0.1 μ F、 35 V	JP1 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
C14	Ceramic	0.1 μ F、 630 V	JP2 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
J1	Pin header	1 × 08	JP3 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
J2	Pin header	1 × 08	JP4 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
J3	Pin header	1 × 02	JP5 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
J4	Pin header	B2P3-VH 相当	JP6 ⁽³⁾⁽⁴⁾	Jumper	Open
J5	Pin header	B3P5-VH 相当	JP7 ⁽⁵⁾	Jumper	Short
R1	General	2.2 k Ω 、 0.25 W	JP8	Jumper	Open
R2	General	2.2 k Ω 、 0.25 W	D1	General	1 A、 50 V
R3	General	Short	D2	Zener	$V_Z = 20$ V、 0.5 W
R4	General	Open	IPM1	IC	SIM2602M
R5	General	Short			

⁽¹⁾ ホール素子信号のノイズ対策用コンデンサ。必要に応じて接続

⁽²⁾ VSP 端子に入力する速度制御信号のノイズ対策用抵抗。必要に応じて接続

⁽³⁾ S 極検知のホール IC の信号を入力する場合は JP1、JP3、JP5 をショート、JP2、JP4、JP6 をオープン

⁽⁴⁾ N 極検知のホール IC の信号を入力する場合は JP1、JP3、JP5 をオープン、JP2、JP4、JP6 をショート

⁽⁵⁾ R11 を接続する場合はオープン、接続しない場合はショート

注意書き

- 本書に記載している製品（以下、「本製品」という）のデータ、図、表、およびその他の情報（以下、「本情報」という）は、本書発行時点のものです。本情報は、改良などで予告なく変更することがあります。本製品を使用する際は、本情報が最新であることを弊社販売窓口に確認してください。
- 本製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）の部品に使用されることを意図しております。本製品を使用する際は、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災装置、防犯装置、各種安全装置など）に本製品を使用することを検討する際は、必ず事前にその使用の適否について弊社販売窓口へ相談いただき、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。本製品は、極めて高い信頼性が要求される機器または装置（航空宇宙機器、原子力制御、その故障や誤動作が生命や人体に危害を及ぼす恐れのある医療機器（日本における法令でクラスⅢ以上）など）（以下「特定用途」という）に使用されることを意図されておりません。特定用途に本製品を使用したことでお客様または第三者に生じた損害などに関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用するにあたり、本製品に他の製品や部材を組み合わせる際、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他の何らかの加工や処理を施す際は、使用者の責任においてそのリスクを必ず検討したうえで行ってください。
- 弊社は、品質や信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は、ある確率で欠陥や故障が発生することは避けられません。本製品が故障し、その結果として人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないように、故障発生率やディレーティングなどを考慮したうえで、使用者の責任において、本製品が使用される装置やシステム上で、十分な安全設計および確認を含む予防措置を必ず行ってください。ディレーティングについては、納入仕様書および弊社ホームページを参照してください。
- 本製品は、耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載している回路定数、動作例、回路例、パターンレイアウト例、設計例、推奨例、本書に記載しているすべての情報、およびこれらに基づく評価結果などは、使用上の参考として示したものです。
- 本情報に起因する使用者または第三者のいかなる損害、および使用者または第三者の知的財産権を含む財産権とその他一切の権利の侵害問題について、弊社は一切その責任を負いません。
- 本情報を、文書による弊社の承諾なしに転記や複製をすることを禁じます。
- 本情報について、弊社の所有する知的財産権およびその他の権利の実施、使用または利用を許諾するものではありません。
- 使用者と弊社との間で別途文書による合意がない限り、弊社は、本製品の品質（商品性、および特定目的または特別環境に対する適合性を含む）ならびに本情報（正確性、有用性、および信頼性を含む）について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしておりません。
- 本製品を使用する際は、特定の物質の含有や使用を規制する RoHS 指令など、適用される可能性がある環境関連法令を十分に調査したうえで、当該法令に適合するように使用してください。
- 本製品および本情報を、大量破壊兵器の開発を含む軍事用途やその他軍事利用の目的で使用しないでください。また、本製品および本情報を輸出または非居住者などに提供する際は、「米国輸出管理規則」や「外国為替及び外国貿易法」など、各国で適用される輸出管理法令などを遵守してください。
- 弊社物流網以外における本製品の落下などの輸送中のトラブルについて、弊社は一切その責任を負いません。
- 本書は、正確を期すために慎重に製作したのですが、本書に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本情報の誤りや欠落に起因して、使用者に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用する際の一般的な使用上の注意は弊社ホームページを、特に注意する内容は納入仕様書を参照してください。
- 本書で使用されている個々の商標、商号に関する権利は、弊社を含むその他の原権利者に帰属します。